

TLV612901 具有旁路模式和 I²C 接口的 5.5V、11A 同步升压转换器

1 特性

- 1.8V 到 5.5V 的宽 V_{IN} 范围
 - 2.2V 启动输入电压
- 通过 I²C 实现可编程平均输入电流限制 (3.5A 至 11A)，默认值为 8A
- 通过 I²C 实现可编程输出电压 (2.35V 至 5.5V)，默认值为 5.0V
- 较高的效率和功率容量
 - 默认 8A 平均输入电流限制
 - 两个 8m Ω (LS)/8m Ω (HS) MOSFET
 - 10m Ω 旁路 MOSFET
 - $V_{IN} = 4.2V$ 、 $V_{OUT} = 5.0V$ 且 $I_{OUT} = 1.5A$ 时峰值效率为 96.3%
 - 效率高达 94.4% ($V_{IN} = 4.2V$ 、 $V_{OUT} = 5.0V$ 且 $I_{OUT} = 4A$ 时)
- $V_{IN} > V_{OUT}$ 时自动旁路模式
- 可在轻负载下选择自动 PFM、强制 PWM 或超声波模式
- EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
- 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
- 热关断和过流保护
- 输出短路保护
- 与 I²C 兼容的接口速率高达 1Mbps
- 1.2V I/O 逻辑控制接口
- 16 焊球 WCSP 封装

2 应用

- 手机
- 平板电脑
- 光学模块
- 4G、5G 小型模块数据卡
- 卫星通信
- 射频功率放大器

3 说明

TLV612901 是一款具有集成旁路模式的 5.5V、11A 同步升压转换器，适用于单节电池供电系统。该器件可在宽输入电压范围内运行，并支持 2.2V 的启动。输出电压可通过 I²C 进行编程，范围为 2.35V 至 5.5V，默认值为 5.0V。TLV612901 经过优化，可在宽电池工作范围内实现高功率能力、快速瞬态响应和高效率。

TLV612901 可用作高功率前置稳压器，以在延长电池运行时间的同时克服供电系统的输入压降和输入电流限制。当输入电压高于目标输出电压时，该器件会自动进入旁路模式以实现卓越效率。当输入电压降至目标输出电压以下时，该器件会无缝转换至升压模式，以保持稳定的输出电压并能够充分利用电池容量。该器件还支持通过 I²C 实现强制旁路操作。

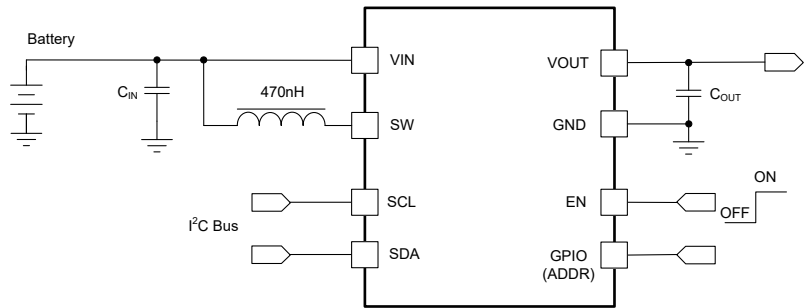
TLV612901 还支持可选轻负载工作模式、关断期间的输出放电，以及输入和输出之间的真正断开。TLV612901 可采用 16 焊球 WCSP 封装。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TLV612901	YBG (DSBGA, 16)	1.577mm × 1.577mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 12。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



简化版应用电路



内容

1 特性	1	8.2 CONFIG 寄存器	25
2 应用	1	8.3 VOUTFLOORSET 寄存器	26
3 说明	1	8.4 ILIMBSTSET 寄存器	27
4 器件比较表	3	8.5 VOUTROOFSET 寄存器	28
5 引脚配置和功能	4	8.6 STATUS 寄存器	29
6 规格	5	8.7 ILIMPTSET 寄存器	30
6.1 绝对最大额定值.....	5	8.8 BSTLOOP 寄存器	31
6.2 ESD 等级.....	5	9 应用和实施	32
6.3 建议运行条件.....	5	9.1 应用信息.....	32
6.4 热性能信息.....	5	9.2 典型应用.....	32
6.5 电气特性.....	6	9.3 电源相关建议.....	38
6.6 I ² C 接口时序要求.....	9	9.4 布局.....	38
6.7 典型特性.....	10	10 器件和文档支持	41
7 详细说明	12	10.1 器件支持.....	41
7.1 概述.....	12	10.2 接收文档更新通知.....	41
7.2 功能方框图.....	12	10.3 支持资源.....	41
7.3 特性说明.....	13	10.4 商标.....	41
7.4 器件功能模式.....	14	10.5 静电放电警告.....	41
7.5 编程.....	20	10.6 术语表.....	41
8 寄存器映射	23	11 修订历史记录	41
8.1 DeviceID 寄存器.....	24	12 机械、封装和可订购信息	42

4 器件比较表

器件型号	默认输出电压	GPIO 功能	默认 GPIO 配置
TLV612901	5.0V	ADDR	可编程：75h (ADDR = L)，76h (ADDR = H)，77h (ADDR 悬空)
TLV612902 ⁽¹⁾	3.4V 或 3.55V	VSEL	VOUTFLOORSET：(VSEL = 低电平，3.4Vout) VOUTROOFSET：(VSEL = 高电平，3.55Vout)

(1) 产品预发布 (非量产数据)。请联系 TI 工厂获取更多信息。

5 引脚配置和功能

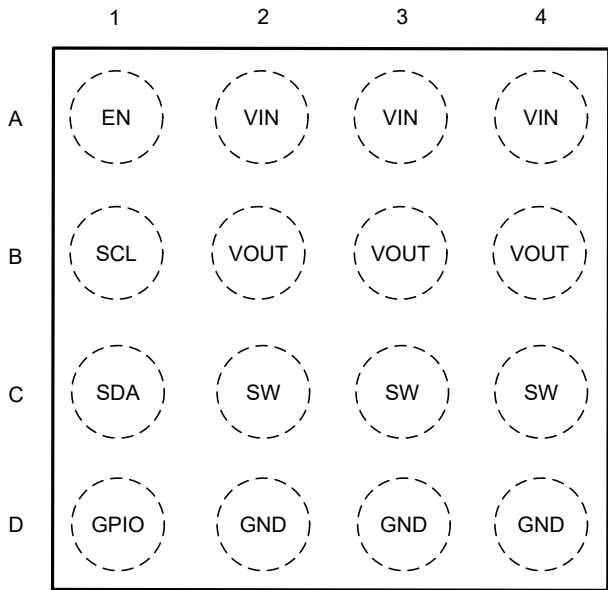


图 5-1. TLV612901 YBG 封装，16 引脚 DSBGA (顶视图)

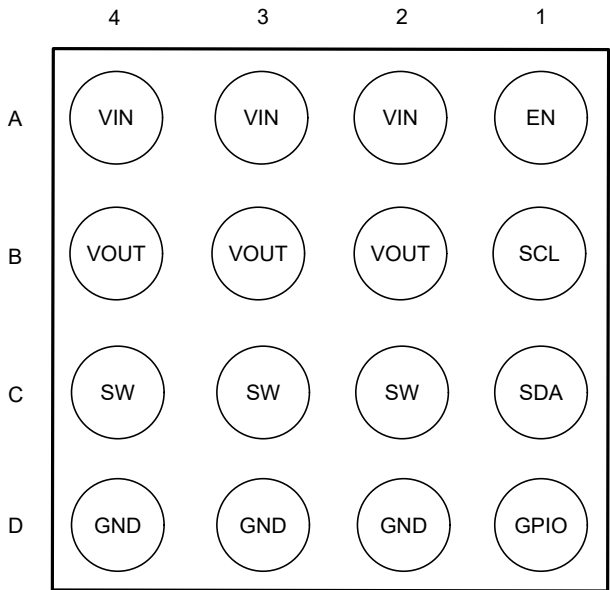


图 5-2. TLV612901 YBG 封装，16 引脚 DSBGA (底视图)

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
EN	A1	I	启用逻辑输入。逻辑高电平启用器件。逻辑低电平禁用器件并使器件进入关断模式。
VIN	A2、A3、A4	PWR	电源输入
SCL	B1	I	串行接口时钟线路。端接该引脚而不将其悬空。
VOUT	B2、B3、B4	PWR	转换器输出
SDA	C1	I	串行接口地址/数据线。端接该引脚而不将其悬空。
SW	C2、C3、C4	PWR	开关节点。该引脚连接到内部低侧 MOSFET 的漏极，以及内部高侧 MOSFET 的源极。
GPIO	D1	I/O	将引脚配置为 ADDR 或 VSEL 功能。对于 TLV612901，默认配置为 ADDR 功能。 ADDR：I ² C 目标地址选择。当 ADDR 为低电平时，I ² C 目标地址为 75h；当 ADDR 为高电平时，I ² C 目标地址为 76h；当 ADDR 悬空时，I ² C 目标地址为 77h。启动序列成功完成后，该地址被锁定。 VSEL：输出电压选择。当 VSEL 处于低电平时，Vout 为 VOUTFLOOR_TH。当 VSEL 为高电平时，Vout 为 VOUTROOF_TH。
GND	D2、D3、D4	PWR	IC 的接地引脚。输出电容器的 GND 焊盘必须靠近 GND 引脚。

(1) I = 输入，O = 输出，PWR = 电源

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
输入电压	VIN、SW、EN、VOUT、SCL、SDA、GPIO ⁽²⁾	DC	-0.3	7	V
输入电压	10ns 时的 SW 尖峰 ⁽²⁾	AC	-0.7	8	V
输入电压	5ns 时的 SW 尖峰 ⁽²⁾	AC	-0.7	8.5	V
输入电流	升压模式下流入 SW 的连续电流 ⁽³⁾			6	A
温度	工作结温, T _J		-40	150	°C
温度	贮存温度, T _{stg}		-65	150	°C

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 所有电压都是相对于网络接地端的电压。
- (3) 在 6A 输出电流下持续运行且结温高于 85°C 时,工作寿命会缩短。

6.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	±500	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。若部署必要的预防措施, 不足 500V HBM 时也能进行生产。列为 ±2000V 的引脚实际上可能具有更高的性能。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。若部署必要的预防措施, 不足 250V CDM 时也能进行生产。列为 ±500V 的引脚实际上可能具有更高的性能。

6.3 建议运行条件

		最小值	标称值	最大值	单位
V _{IN}	输入电压范围	1.8		5.5	V
V _{OUT}	输出电压设置范围	2.35		5.5	V
L	有效电感范围	330	470	560	nH
C _{in}	有效输入电容范围		5		μF
C _O	有效输出电容范围, I _{out} ≤ 4A	15	20		μF
	有效输出电容范围, 4A < I _{out} ≤ 6A	20			μF
T _J	工作结温	-40		125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TLV612901	TLV612901	单位
		YBG (16 引脚)	YBG (16 引脚)	
		标准	EVM ⁽²⁾	
R _{θJA}	结至环境热阻	78	40.5	°C/W
R _{θJC}	结至外壳热阻	0.6	不适用	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	13	不适用	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	2.4	0.1	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	13	16.0	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。

(2) 在 TLV61290EVM-076 上测得，4 层，2oz 覆铜，92.2mm×59.2mm PCB。

6.5 电气特性

$T_J = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C ， $V_{IN} = 1.8\text{V}$ 至 5.5V ， $V_{OUT} = 3.4\text{V}$ （或 V_{IN} ，采用较高者）， $EN = 1.2\text{V}$ ， $GPIO = 1.2\text{V}$ 。典型值均为在 $V_{IN} = 3.2\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.4\text{V}$ 、 $EN = 1.2\text{V}$ 、 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 条件下测得的值（除非另有说明）。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源						
V_{IN}	输入电压范围		1.8		5.5	V
V_{UVLO}	欠压锁定阈值	上升		2.1	2.2	V
V_{UVLO}	欠压锁定阈值	下降		1.7	1.8	V
		迟滞		0.4		V
I_Q	流入 V_{IN} 的工作静态电流	直流/直流升压模式。器件未开关 $EN = V_{IN}$ ， $ENABLE_bit = 01$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		42	57	μA
	流入 V_{OUT} 引脚的工作静态电流	直流/直流升压模式。器件未开关 $EN = V_{IN}$ ， $ENABLE_bit = 01$ $2.35\text{V} \leq V_{OUT} \leq 5.5\text{V}$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		12	23	μA
	自动旁路模式下的工作静态电流	真旁路模式（自动） $EN = V_{IN}$ ， $ENABLE_bit = 01$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		35	49	μA
	强制旁路模式下的工作静态电流	真旁路模式（强制） $EN = V_{IN}$ ， $ENABLE_bit = 10$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		35	47	μA
I_{SD}	关断电流	关断模式 $EN = GND$ ， $V_{OUT} = GND$ $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		0.55	2	μA
	关断电流	关断模式 $EN = GND$ ， $V_{OUT} = GND$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		0.55	11	μA
	关断电流	关断模式，但 I^2C 模块处于活动状态。 $EN = V_{IN}$ ， $ENABLE_bit = 11$ $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		16	23	μA
	关断电流	关断模式，但 I^2C 模块处于活动状态。 $EN = V_{IN}$ ， $ENABLE_bit = 11$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		16	35	μA
EN、SDA、SCL、GPIO						
V_{IL}	低电平输入电压		0.33			V
V_{IH}	高电平输入电压			0.82		V
V_{OL}	低电平输出电压 (SDA)	$I_{OL} = 8\text{mA}$		0.36		V
R_{PD}	EN 下拉电阻	施加电压小于 0.4V		800		k Ω
I_{lkg}	输入漏电流	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 85^{\circ}\text{C}$		0.1		μA
输出						
V_{OUT}	输出电压设置范围		2.35		5.5	V
V_{OUT_PWM}	直流电压精度	$2.2\text{V} \leq V_{IN} \leq V_{OUT_TAR} - 150\text{mV}$ PWM 运行	-1.5		1.5	%
$V_{OUT_BP_ENTER}$	进入旁路模式阈值	$MODE_CTRL = 00$ ，自动 PFM		$V_{OUT_P_WM} \times (1 + 0.5\%)$		V
$V_{OUT_BP_ENTER}$	进入旁路模式阈值	$MODE_CTRL = 10$ ，FPWM		$V_{OUT_P_WM} \times (1 + 2\%)$		V

6.5 电气特性 (续)

$T_J = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C , $V_{IN} = 1.8\text{V}$ 至 5.5V , $V_{OUT} = 3.4\text{V}$ (或 V_{IN} , 采用较高者), $EN = 1.2\text{V}$, $GPIO = 1.2\text{V}$ 。典型值均为在 $V_{IN} = 3.2\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.4\text{V}$ 、 $EN = 1.2\text{V}$ 、 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 条件下测得的值 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT_BP_EXIT}	退出旁路模式阈值	自动旁路模式	$V_{OUT_PWM} \times (1 - 3\%)$			V
V _{OVP}	输出过压保护阈值	V _{OUT} 上升	5.45	5.58	5.70	V
R _{DIS_OUT}	输出等效放电阻抗		90			Ω
电源开关						
R _{DS(on)}	低侧开关 MOSFET 导通电阻	V _{OUT} = 5V	8 13.5			mΩ
	高侧整流器 MOSFET 导通电阻	V _{OUT} = 5V	8 13.5			mΩ
	低侧开关 MOSFET 导通电阻	V _{OUT} = 3.4V	10 15			mΩ
	高侧整流器 MOSFET 导通电阻	V _{OUT} = 3.4V	10 15			mΩ
	旁路 MOSFET 导通电阻	V _{OUT} = 2.35V 至 5.5V	10 15			mΩ
I _{LIM_SW}	平均电感器电流限值	ILIM_BOOST = 0110 (默认值) , 1.8V ≤ V _{IN} ≤ 5.5V	6	8	9	A
	通过 I ² C 实现可调节平均电感器电流限值范围	典型值, 1.8V ≤ V _{IN} ≤ 5.5V	3.5	11		A
ILIM_REVERSE	反向电流限值 (FPWM 运行)	MODE_CTRL = 10	-1			A
I _{LIM_BP}	旁路模式电流限值 (强制)	ENABLE_bit = 10 , ILIM_FPT = 010 (默认值)	6.5	8	11.2	A
	旁路模式电流限值 (自动)	ENABLE_bit = 01 , ILIM_APT = 010 (默认值)	6.5	8	11.2	A
I _{lkg}	低侧开关 MOSFET 漏电流	EN = GND , - 40°C ≤ T _J ≤ 85°C	0.1		5	μA
	高侧开关 MOSFET 漏电流	EN = GND , - 40°C ≤ T _J ≤ 85°C	0.1		5	μA
	旁路 MOSFET 漏电流	EN = GND , - 40°C ≤ T _J ≤ 85°C	0.6		5	μA
振荡器						
T _{ON_MIN}	最小导通时间	PWM 模式	80			ns
F _{sw_min_fpwm}	FPWM 模式下的最小开关频率	MODE_CTRL = 10	375	440	kHz	
F _{sw_min_pfm}	超声波模式下的最小开关频率	MODE_CTRL = 01	23		kHz	
F _{DITHER}	展频抖动频率	V _{IN} = 3.2V , V _{OUT} = 3.4V , MODE_CTRL = 10 , SSFM = 1	±8%			F _{sw}
热关断						
T _{SD}	热关断 ⁽¹⁾	T _J 上升	165			°C
T _{SD_HYS}	热关断迟滞 ⁽¹⁾		20			
定时						
	软启动时间 ⁽¹⁾	内部 SS 斜坡时间	400			μs
	断续导通时间	HICCUP_MODE 位 = 1	1			ms

6.5 电气特性 (续)

$T_J = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C , $V_{IN} = 1.8\text{V}$ 至 5.5V , $V_{OUT} = 3.4\text{V}$ (或 V_{IN} , 采用较高者) , $EN = 1.2\text{V}$, $GPIO = 1.2\text{V}$ 。典型值均为在 $V_{IN} = 3.2\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.4\text{V}$ 、 $EN = 1.2\text{V}$ 、 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 条件下测得的值 (除非另有说明) 。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	断续停止时间	HICCUP_MODE 位 = 1		19		ms

(1) 通过表征进行验证。未经量产测试。

6.6 I²C 接口时序要求

在工作结温范围和推荐的电源电压范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

参数		测试条件	最小值 最大值	单位
f _(SCL)	SCL 时钟频率	标准模式	100	kHz
f _(SCL)	SCL 时钟频率	快速模式	400	kHz
f _(SCL)	SCL 时钟频率	快速模式 +	1	MHz
t _{BUF}	停止与启动条件之间的总线空闲时间	快速模式 +	0.5	μs
t _{HD} 、 t _{STA}	（重复）启动条件后 的保持时间		260	ns
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期		0.5	μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期		260	ns
t _{SU} 、 t _{STA}	重复启动条件的建立时间		260	ns
t _{SU} 、 t _{DAT}	数据建立时间		50	ns
t _{HD} 、 t _{DAT}	数据保存时间		0	μs
t _{RCL}	SCL 信号的上升时间		120	ns
t _{RCL1}	重复启动条件和确认位之后的 SCL 信 号上升时间		120	ns
t _{FCL}	SCL 信号的下降时间		120	ns
t _{RDA}	SDA 信号的上升时间		120	ns
t _{FDA}	SDA 信号的下降时间		120	ns
t _{SU} 、 t _{STO}	停止条件的建立时间		260	ns
C _B	SDA 和 SCL 的容性负载		200	pF

(1) 根据设计指定。未经量产测试。

6.7 典型特性

典型条件为 $V_{IN} = 2.5V$ 至 $4.5V$ 、 $V_{OUT_TAR} = 5.0V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ ，除非另有说明

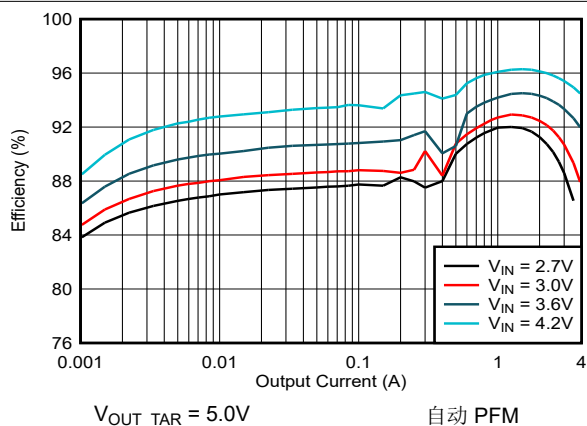


图 6-1. 效率与输出电流之间的关系

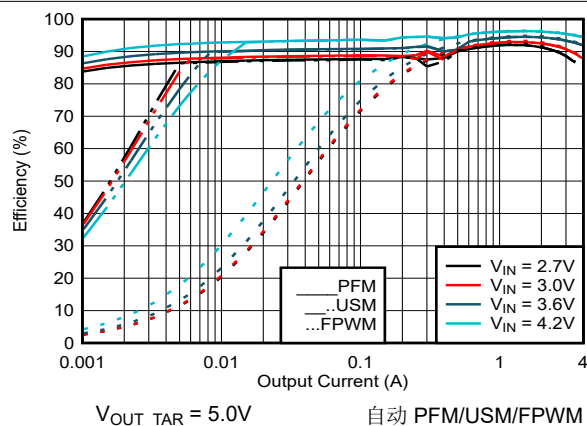


图 6-2. 效率与输出电流之间的关系

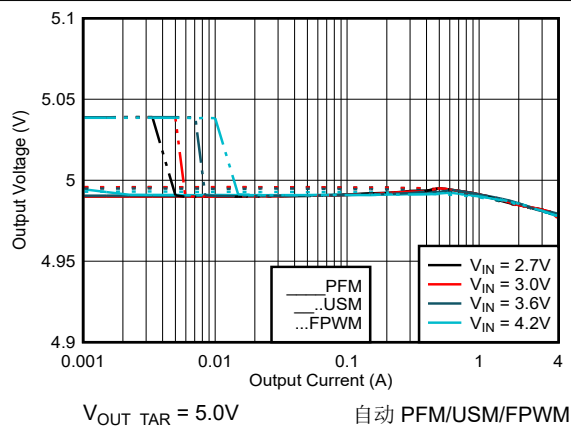


图 6-3. DC 输出电压与输出电流间的关系

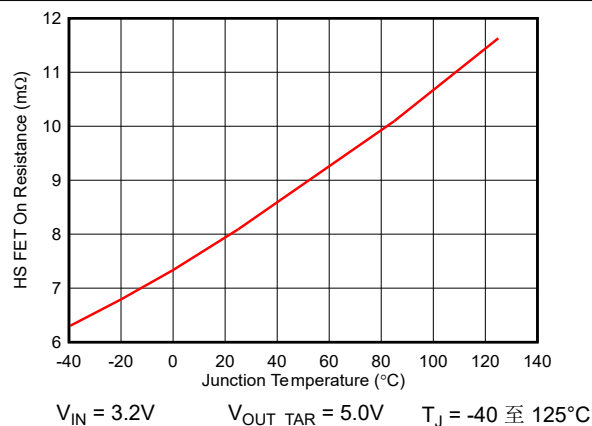


图 6-4. 高侧 $R_{ds(on)}$ 与结温间的关系

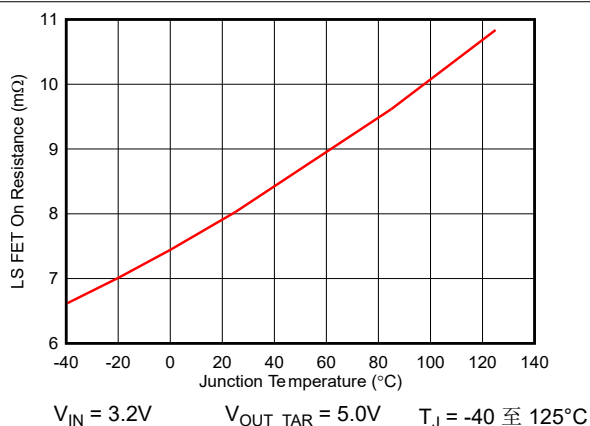


图 6-5. 低侧 $R_{ds(on)}$ 与结温间的关系

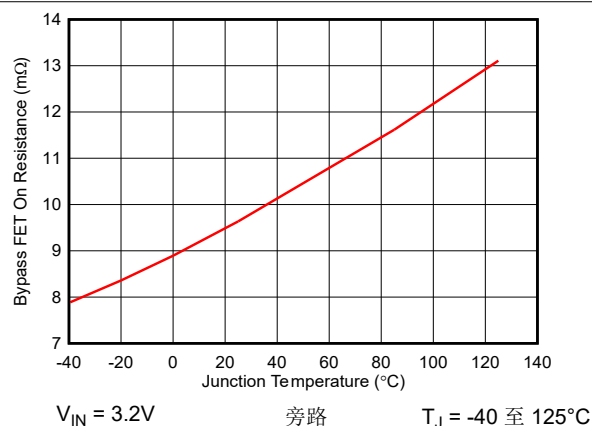


图 6-6. 旁路 FET $R_{ds(on)}$ 与结温间的关系

6.7 典型特性 (续)

典型条件为 $V_{IN} = 2.5V$ 至 $4.5V$ 、 $V_{OUT_TAR} = 5.0V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ ，除非另有说明

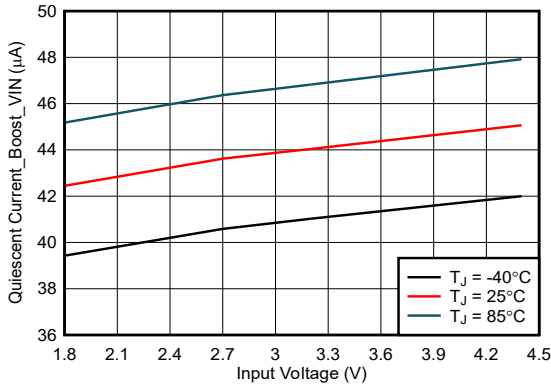


图 6-7. 升压模式下流入 V_{IN} 的静态电流与输入电压间的关系

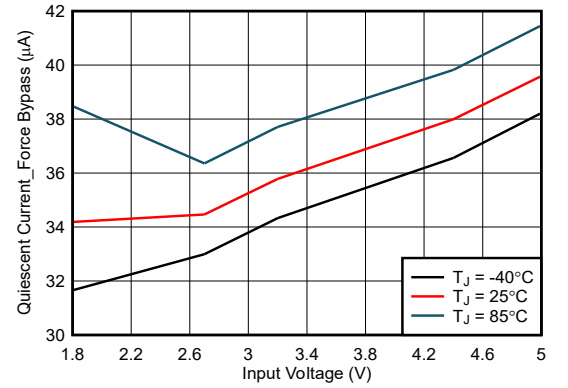


图 6-8. 强制旁路模式下静态电流与输入电压间的关系

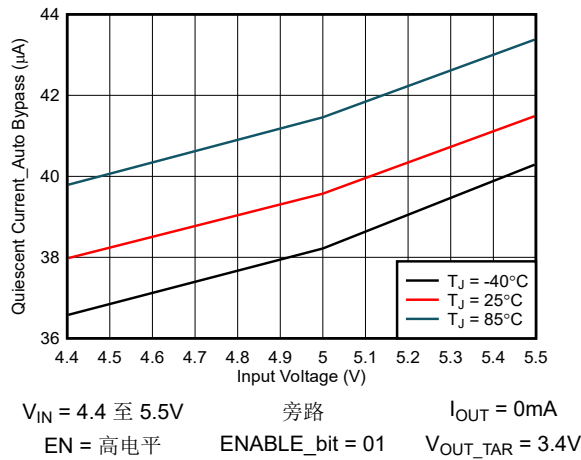


图 6-9. 自动旁路模式下静态电流与输入电压间的关系

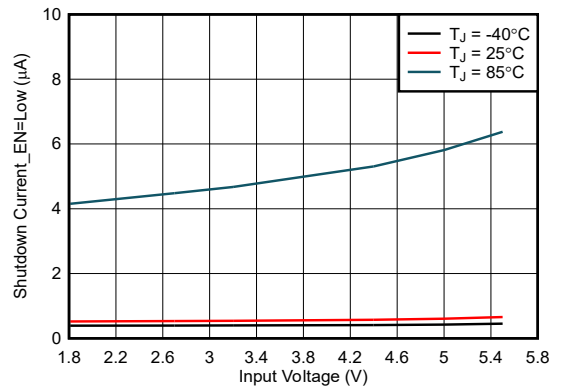


图 6-10. EN = 低电平时关断电流与输入电压间的关系

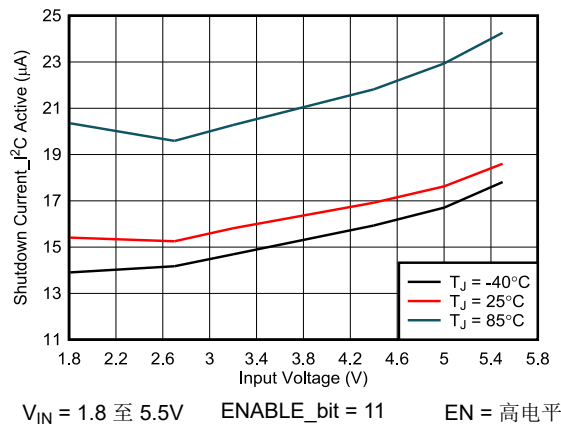


图 6-11. I²C 模块活动时的关断电流与输入电压间的关系

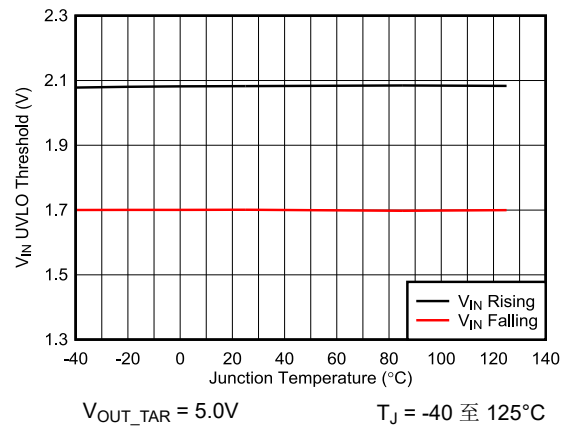


图 6-12. V_{IN} UVLO 上升/下降阈值与结温间的关系

7 详细说明

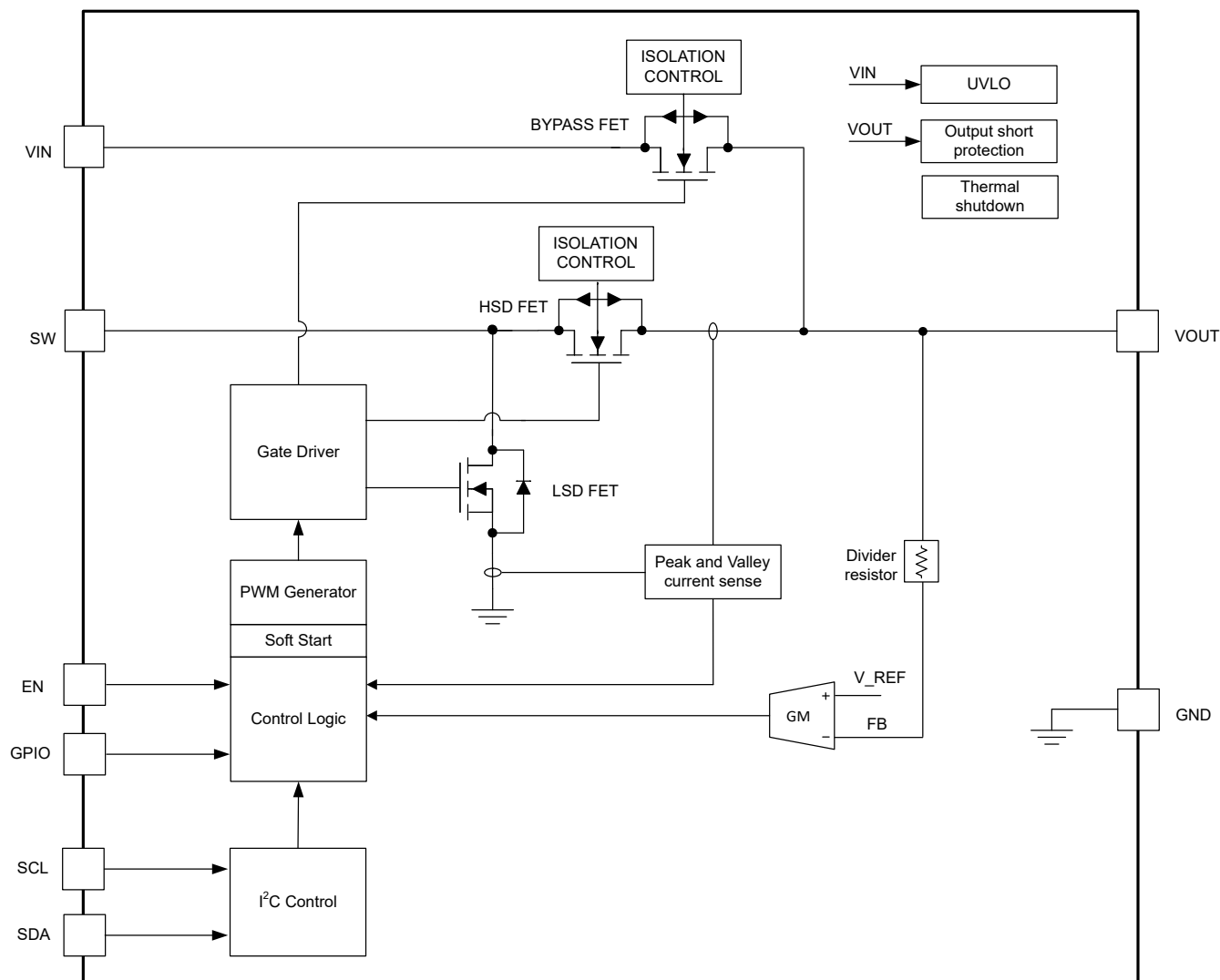
7.1 概述

TLV612901 是一款具有集成旁路模式的高效同步升压转换器，针对单节电池供电系统进行了优化。该器件包含一个 $8\text{m}\Omega$ 低侧功率 MOSFET、一个 $8\text{m}\Omega$ 高侧整流器 MOSFET 和一个 $10\text{m}\Omega$ 旁路 MOSFET，可在宽输入电压范围内实现高效率。TLV612901 的默认平均输入电流限制为 8A，为需要 5.5V 稳定电源的系统支持高功率能力。

TLV612901 支持升压模式和旁路模式运行。当输入电压高于目标输出电压时，该器件在旁路模式下运行，以便更最大限度地提高效率并减小输入至输出压降。当输入电压降至目标输出电压以下时，该器件转换至升压模式以保持稳定的输出电压。该运行方案使系统能够在宽电池电压范围内保持性能，同时延长电池运行时间。

TLV612901 使用迟滞电流模式控制方案，集成了一个与 I²C 兼容的接口，支持高达 1Mbps 的传输。使用此通信接口来设置升压与旁路模式之间的输出电压切换阈值、重新配置工作模式（自动 PFM、强制 PWM 或超声波模式），以及设置平均电流限值或输出电压。这些特性使 TLV612901 能够在便携式应用中支持高负载运行和提高的轻负载效率。对于 TLV612901，GPIO 引脚的默认配置为 ADDR 功能，允许在同一 I²C 总线上配置多达三个芯片。当 ADDR 为低电平时，I²C 目标地址为 75h；当 ADDR 为高电平时，I²C 目标地址为 76h；当 ADDR 悬空时，I²C 目标地址为 77h。

7.2 功能方框图



$$\delta = \frac{\Delta f_c}{f_c} \quad (2)$$

最大开关频率 f_c 受限于过程，最终由参数调制比 (δ)，以及载波频率 f_c 周围的边带谐波带宽 f_m 共同决定。卡森法则大致给出了调频波形的带宽。使用 [方程式 3](#) 总结：

$$B = 2 \times f_m \times (1 + m_f) = 2 \times (\Delta f_c + f_m) \quad (3)$$

$f_m < \text{RBW}$ ：接收器无法区分单个边带谐波，因此输入滤波器中叠加了多个谐波，测量值高于理论计算中的预期值。

$f_m > \text{RBW}$ ：接收器能够正确测量每个单独的边带谐波，因此测量值与理论计算值相匹配。

7.4 器件功能模式

7.4.1 使能和启动

一旦施加大于 2.2V 的输入电压，TLV612901 就会自动上电。启动后，输入电压范围降低至 1.8V。器件配有内部软启动电路，可限制启动期间的浪涌电流。

启动过程的第一个阶段是将输出节点偏置到接近输入电平（也称为降压模式预充电阶段）。在此运行模式下，当 VIN 超过 2.8V 时，TLV612901 有三个运行条件：

- 当输出电压低于 0.8V 时，电感器平均电流限制到约 0.5A。
- 当输出电压高于 0.8V 但低于输入电压减去 2.0V 时，电感器平均电流限值增加到约 1.5A。
- 当输出电压高于输入电压减去 2V 但低于输入电压时，平均电感电流限值会提升至升压电流限值的二分之一（约 4 A）。

当 VIN 不超过 2.8V 时，TLV612901 在降压模式预充电阶段只有两个工作条件。[表 7-1](#) 展示了此操作的更多详细信息。

启动过程的第二个阶段是升压开关阶段。在这种运行模式下，输出电压高于输入电压，平均电感器电流限制增加至升压电流限制（默认值为 8A）。

使用这种方法可提高启动期间的负载能力，这有助于减少启动期间的浪涌电流。[表 7-1](#) 和 [表 7-2](#) 显示了平均电感电流限制与启动阶段输出电压之间的关系。

表 7-1. 启动期间的平均电感器电流限值设置 ($V_{IN} \leq 2.8V$)

PHASE	平均电感器电流限值	输出电压
降压模式预充电阶段	0.5A (典型值)	$V_{OUT} \leq 0.8V$
	4A (典型值)	$0.8V < V_{OUT} \leq V_{IN}$
升压开关阶段	8A (典型值)	$V_{IN} < V_{OUT}$

表 7-2. 启动期间的平均电感器电流限值设置 ($V_{IN} > 2.8V$)

PHASE	电感器平均电流限值	输出电压
降压模式预充电阶段	0.5A (典型值)	$V_{OUT} \leq 0.8V$
	1.5A (典型值)	$0.8V < V_{OUT} \leq V_{IN} - 2.0V$
	4A (典型值)	$V_{IN} - 2.0V < V_{OUT} \leq V_{IN}$
升压开关阶段	8A (典型值)	$V_{IN} < V_{OUT}$

在降压模式的预充电阶段, 如果 1ms 后输出电压未达到输入电压, TLV612901 将触发保护并停止开关。然后, 器件保持等待状态 19ms, 然后尝试再次重新启动。

TLV612901 能够在 2.2V 的 UVLO 上升阈值下启动。但是, 如果启动期间的负载过高或输出电容太大以至于 TLV612901 无法将输出电压充电至目标值, 则在输入电压增大或负载电流减小之前, TLV612901 均无法成功启动。总启动时间取决于输入电压、输出电容和负载电流。

7.4.2 运行模式设置

可配置 TLV612901 器件 (通过节 8.2) 以选择运行模式。

当 EN 引脚设置为逻辑高电平、ENABLE 位 (CONFIG[5:6]) = 01 (默认值) 时, 器件进入正常模式 (即自动升压/旁路模式), 并使输出电压保持在预定义的目标电压以上。

当 EN 引脚设置为逻辑高电平、ENABLE 位 (CONFIG[5:6]) = 10 时, 器件将进入强制旁路模式。 V_{OUT} 随 V_{IN} 变化。该模式下的电流限制为 8A (可通过 I²C 编程)。由于旁路 MOSFET 上的压降, 输出电压会略有降低。该器件仅消耗 35μA (典型值) 的待机电流。

当 EN 引脚设置为逻辑高电平且 ENABLE 位 (CONFIG[5:6]) = 11 时, 器件会强制处于关断模式, 但 I²C 模块正常工作, 待机电流典型值为 16μA。在该模式下, 电池和负载之间的真正负载断开可防止电流从 V_{IN} 流向 V_{OUT} , 同时防止反向电流从 V_{OUT} 流向 V_{IN} 。

当 EN 引脚设置为逻辑低电平时, 会强制器件处于关断模式 (无论 ENABLE 位是何设置), 关断电流典型值为 0.55μA。在该模式下, 电池和负载之间的真正负载断开可防止电流从 V_{IN} 流向 V_{OUT} , 同时防止反向电流从 V_{OUT} 流向 V_{IN} 。

表 7-3. 运行模式

EN 引脚	使能位	运行模式
低	xx	关断模式。真正负载断开且输出电压为 0V。器件关断电流典型值约为 0.55 μA。
高	11	I ² C 关断模式。功率级关断且输出电压为 0V, 但 I ² C 处于活动状态。真负载断开。该模式下的器件待机电流典型值约为 16 μA。
高	10	强制旁路模式。 V_{OUT} 随 V_{IN} 变化。器件待机电流典型值约为 35 μA。
高	00/01 (默认值 01)	自动升压/旁路模式。在升压模式下, $V_{OUT} = V_{OUT_TAR}$ (默认为 5.0V)。在旁路模式下, V_{OUT} 随 V_{IN} 变化。

7.4.3 旁路模式

TLV612901 包含一个内部开关, 用于在旁路模式期间旁路直流/直流升压转换器。当输入电压大于预设输出电压时, 转换器无缝切换至 0% 占空比运行模式, 旁路 FET 完全导通。

在自动 PFM 模式下, 进入自动旁路模式由 $V_{OUT} > (1 + 0.5\%) \times V_{OUT_TAR}$ and $V_{IN} > V_{OUT} - 20mV$ 条件触发。

在强制 PWM 模式下，当满足以下两个条件时，器件进入旁路模式：

- $V_{OUT} > (1 + 2\%) \times V_{OUT_TAR}$ 。
- 连续出现七个周期的最大钳位关断时间（单个周期的 t_{OFF} 典型值为 $2.25 \mu s$ ，总计 $16 \mu s$ ）。

自动旁路模式退出被触发旁路电流限制或 $V_{OUT} < (1 - 3\%) \times V_{OUT_TAR}$ 。

当 **ENABLE** 位 (**CONFIG[5:6]**) = 10 时，器件配置为强制旁路模式。当 $V_{IN} > V_{OUT} + 30mV$ 时，该器件进入强制旁路模式。强制旁路模式退出会被旁路电流限制触发。

在旁路模式下，负载（例如 RF PA）由电池直接供电，从而显著提高输出功率、效率，并尽可能降低输入到输出电压差。该器件仅消耗 $35\mu A$ （典型值）的待机电流。在旁路模式下，该器件通过快速电流限值检测方案实现短路保护。

在此操作期间，输出电压与输入电压保持一致。在旁路模式下，于存在旁路 MOSFET，输出压降取决于输入电压、旁路 MOSFET 的 $R_{DS(on)}$ 和输出电流。使用以下公式来计算输出电压：

$$V_{OUT} = V_{IN} - (R_{DS(on)(BP)} \times I_{OUT}) \quad (4)$$

相反，以下公式给出了旁路模式下的效率：

$$\eta = 1 - R_{DS(on)(BP)} \frac{I_{OUT}}{V_{IN}} \quad (5)$$

- $R_{DS(on)(BP)}$ 为旁路 FET 的典型导通电阻

在旁路模式期间，TLV612901 器件通过快速电流限值检测方案实现过流和短路保护。如果旁路 FET 中的电流超过约 8A（可通过 I²C 编程设定），旁路 FET 会关断，随后 TLV612901 将进入输出接地短路保护模式。解除过流或短路之后，TLV612901 再次执行启动程序。

7.4.4 升压控制操作

TLV612901 升压转换器由滞环电流模式进行控制。此控制器调节输出电压的方式是：将电感器纹波电流保持在 1.0A 左右，然后根据输出负载调节此电感器电流的偏移量。由于输入电压、输出电压和电感器值都会影响电感器纹波电流的上升和下降斜率，因此开关频率不是固定的，而是由工作条件决定。

在轻负载条件下，TLV612901 实现了三种运行模式：自动 PFM 模式、强制 PWM 模式和超声波模式，可满足不同的应用要求。运行模式可通过 I²C 更改 **MODE_CTRL** 位的状态来设置。当 **MODE_CTRL** = 00 时，器件在自动 PFM 模式下运行。当 **MODE_CTRL** = 01 时，器件在超声波模式下运行。当 **MODE_CTRL** = 10 或 11 时，器件在强制 PWM 模式下运行。对于此器件，建议的电感范围为 330nH 至 560nH。

7.4.5 自动 PFM 模式

TLV612901 将省电模式与脉冲频率调制（自动 PFM）集成在一起，以提高轻负载时的效率。在此模式下，如果所需的平均电感器电流低于由这个恒定纹波确定的平均电感器电流，电感器电流会不连续，以便在轻负载条件下保持高效率。峰值电感器电流和谷值电感器电流分别限制在大约 1.0A 和 0A。如果不再支持自动 PFM 模式下的输出电流，则 TLV612901 会退出自动 PFM 模式并进入 PWM 模式。

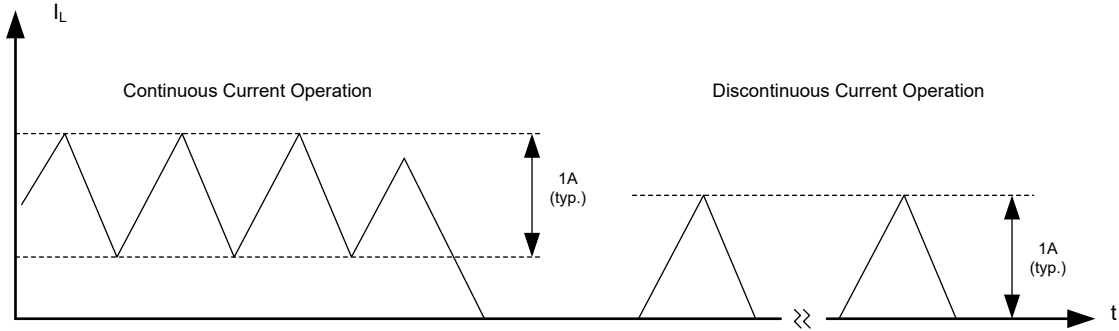


图 7-3. 自动 PFM 模式

7.4.6 强制 PWM 模式

在强制 PWM 模式下，TLV612901 可以在整个负载范围内保持连续电感器电流。当负载电流减小时，内部误差放大器的输出也会降低，使电感器峰值电流降低，从而减少从输入到输出的功率。即便流经 FET 的电流变为负值，高侧 FET 也不会关断，这一设计确保电感电流能够保持连续。同时，开关频率不会随负载发生显著变化。在此模式下，当输入电压接近输出电压时，最小开关频率限制为 375kHz。

7.4.7 超声波模式

超声波模式是独有的控制功能，可在空载和轻负载条件下将开关频率保持在可闻声频以上。超声波模式控制电路会监测开关频率，并将开关频率保持在 23kHz 以上以避免声频段。输出电压通常比 PWM 工作电压高 1%。

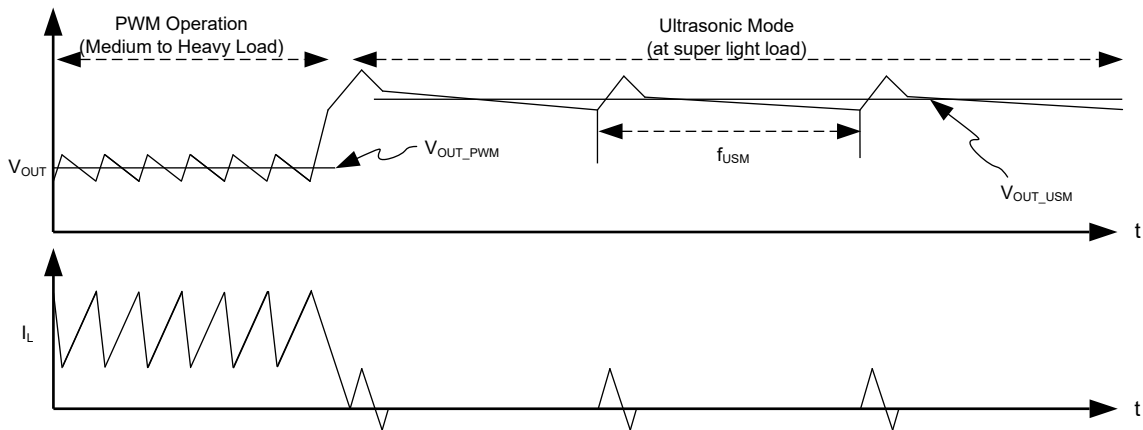


图 7-4. 超声波模式运行

7.4.8 输出放电

TLV612901 提供有源下拉电阻，以便在 EN 为逻辑低电平且器件处于关断模式时使输出快速放电。借助于这个功能，输出电压通过内部电路接地，从而防止输出端“悬空”或进入未定义状态。输出放电功能可使上电和断电时序变得顺畅。如果在电源多路复用等应用中使用此器件，请注意输出放电功能，因为输出放电电路会在多路复用器输出端和接地端之间创建恒流路径。TLV612901 的输出等效放电阻抗为 90Ω (典型值)。

TLV612901 可通过 I²C 写入 DISCHG 位的值来修改此功能状态。当 DISCHG = 0 时，在 I²C 关断模式下禁用输出放电功能。当 DISCHG = 1 时，在关断模式下启用输出放电功能。该位的默认值为 1。

7.4.9 欠压锁定

欠压锁定电路可防止器件在低输入电压时出现故障，还可防止电池过度放电。一旦 V_{IN} 下降到触发欠压锁定阈值 V_{UVLO_falling} (最大值 1.8V)，I²C 控制接口和转换器的输出级就会被禁用。一旦 V_{IN} 上升到触发 V_{UVLO_rising} 阈值 (最大值 2.2V)，器件就开始工作。

7.4.10 电流限值运行

TLV612901 支持平均电感器电流限值方案。

在直流/直流升压模式下，TLV612901 器件采用平均电感器电流限值检测方案，在关断期间检测同步整流器上的压降。平均电感器电流限制阈值可通过 I²C 寄存器进行设置，默认值为 8A (典型值)。当达到该电流限制时，如果输出电流继续增加，TLV612901 会降低输出电压，同时将电感器电流保持在电流限制值。

在进入电流限值 (CL) 之前，由方程式 6 计算得出最大连续输出电流 ($I_{OUT(max)}$)。

$$I_{OUT(max)} = I_{LIMIT} \times \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}} \right) \times \eta \quad (6)$$

其中

- η 是效率
- $I_{OUT(max)}$ 为最大输出电流
- I_{LIMIT} 为输入侧的电流限值
- V_{IN} 是输入电压
- V_{OUT} 是输出电压

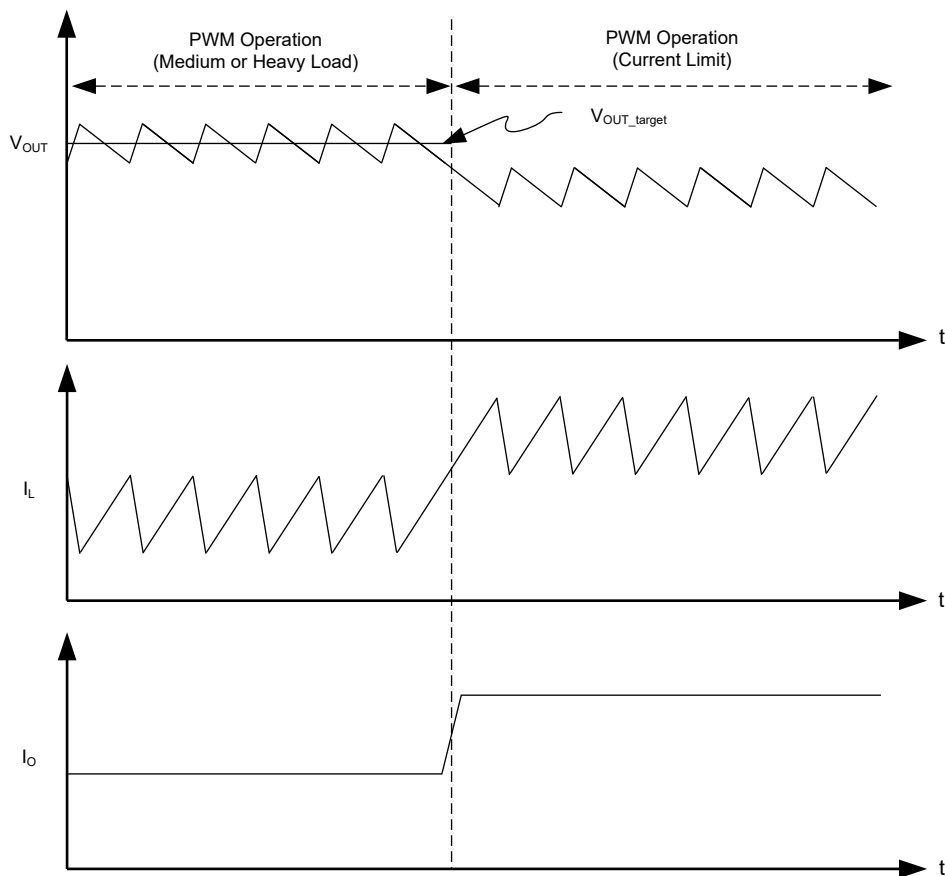


图 7-5. 直流/直流升压模式下的电流限值运行方案

在旁路模式下，TLV612901 通过快速电流限值检测方案得到保护。如果旁路 FET 中的电流超过约 8A，该器件会在短暂的延迟 (大约 200ns) 后关断旁路 FET。然后，器件会循环执行启动过程。

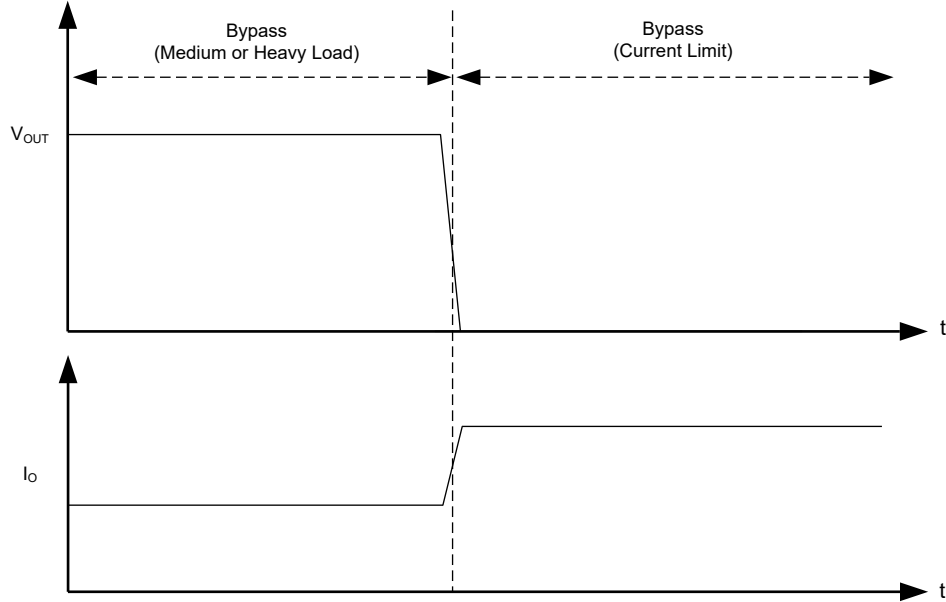


图 7-6. 旁路模式下的电流限值运行方案

7.4.11 输出接地短路保护

TLV612901 在输出接地短路 (OSGP) 时受到保护。输出 OSGP 方案与启动阶段方案相同。

当输出较短时, TLV612901 关闭并循环执行启动过程。解除过流或短路之后, TLV612901 成功进行软启动, 然后调节输出电压。

可以使用 I²C 禁用断续保护模式。

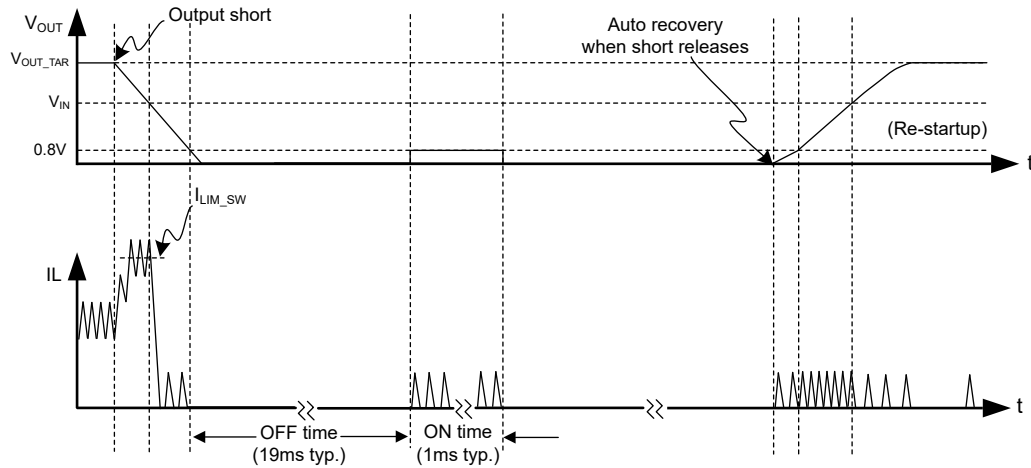


图 7-7. OSGP 的断续模式

7.4.12 过压保护

TLV612901 具有输出过压保护 (OVP) 功能。当输出电压高于典型值 5.58V 时, 器件会停止开关。在输出电压降至低于 OVP 阈值 0.1V 之后, 器件会恢复运行。

7.4.13 热关断

一旦结温 (T_J) 超过 165°C ，器件就会进入热关断状态。在此模式下，旁路、高侧和低侧 MOSFET 均关断，并且 $I^2\text{C}$ 块处于活动状态。当结温降至低于热关断减去其迟滞（典型值为 20°C ）的温度时，器件重新启动并进行输出电压稳压。

7.4.14 电源正常指示状态

TLV612901 还提供电源正常输出位（ $I^2\text{C}$ 中的 PG 位），用于在稳压器成功启动且未发生故障时向系统发出信号。电源正常状态还可用作内核温度过高和过载情况的标志。

- 当启动序列成功完成时，会设置 PG（位 = 1）。
- 在升压模式下，当输出电压降至比其稳压电平低大约 50mV 时，PG 复位（位 = 0）。
- 当器件在自动旁路模式（即 ENABLE 位 = 00 或 01 且 $V_{IN} > V_{OUT}$ ）下运行时，会设置 PG（位 = 1）。
- 当器件在强制旁路模式（即 ENABLE 位 = 10）下运行时，PG 未定义。
- 当器件处于关断模式（即 ENABLE 位 = 11）时，PG 复位（位 = 0）。
- 当器件处于短路保护模式、热关断模式时，PG 复位（位 = 0）。

7.5 编程

TLV612901 使用 $I^2\text{C}$ 接口来灵活地对转换器参数进行编程。 $I^2\text{C}$ 是一种双向 2 线制串行接口。只需要两条总线线路：一条串行数据线 (SDA) 和一条串行时钟线 (SCL)。在执行数据传输时， $I^2\text{C}$ 器件可被视为控制器或目标。控制器是在总线上发起数据传输并生成时钟信号以允许该传输的器件。此时，任何被寻址的器件都被视为目标。

当 ADDR 为逻辑低电平时，TLV612901 作为地址为 75h 的目标器件运行。从控制器器件（例如微控制器或数字信号处理器）接收控制输入，读取和写入内部寄存器 00h 至 07h。TLV612901 的 $I^2\text{C}$ 接口支持标准模式（高达 100kbit/s）和超快速模式（高达 1000kbit/s）。SDA 和 SCL 都必须通过电流源或上拉电阻器连接到正电源电压。当总线空闲时，两条线路都处于高电压。

7.5.1 数据有效性

在时钟的高电平期间，SDA 线上的数据必须保持稳定。数据线的高电平或低电平状态只能在 SCL 线上的时钟信号为低电平时发生变化。为每个已传输的数据位生成一个时钟脉冲。

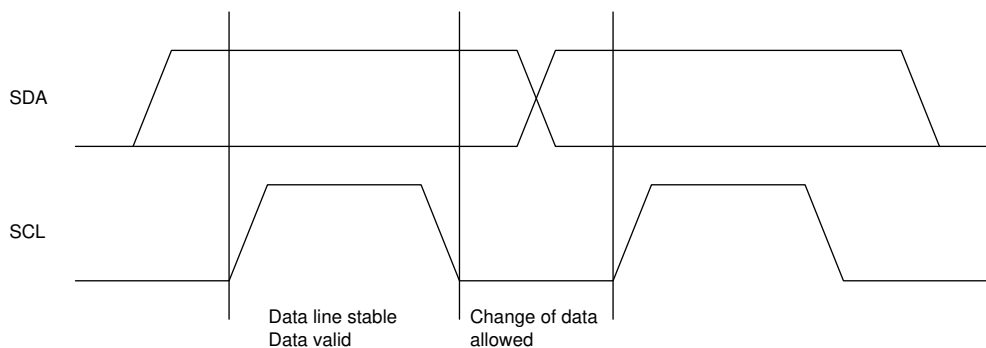


图 7-8. $I^2\text{C}$ 数据有效性

7.5.2 启动条件和停止条件

所有事务均以 START (S) 开始，并可由 STOP (P) 终止。当 SCL 为高电平时，SDA 线上从低电平到高电平的转换将定义 START 条件。当 SCL 为高电平时，SDA 线上从低电平到高电平的转换定义了 STOP 条件。

START 和 STOP 条件始终由控制器产生。总线在 START 条件之后被视为繁忙状态，在 STOP 条件之后被视为空闲状态。

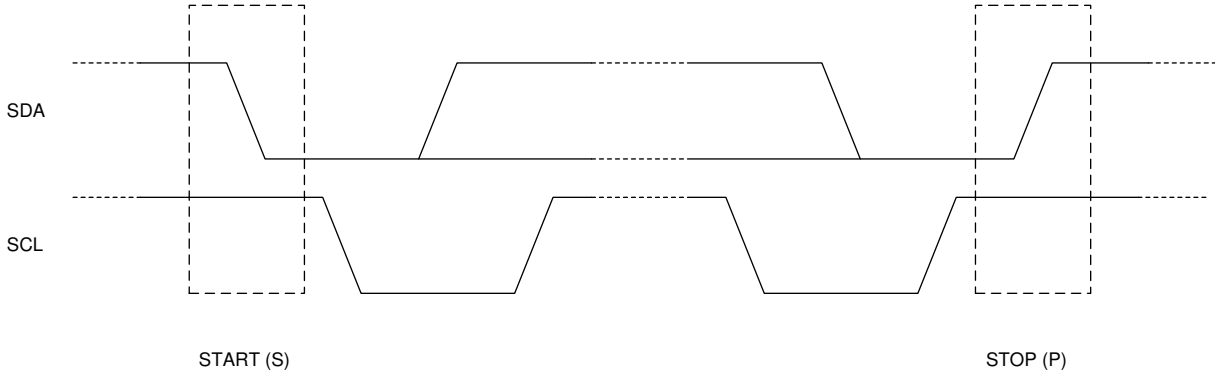


图 7-9. I²C START 和 STOP 条件

7.5.3 字节格式

SDA 线上每个字节的长度都必须为八位。每次传输所要传输的字节数不受限制。每个字节必须后跟一个确认位。传输数据时，最高有效位 (MSB) 优先。如果目标在执行完某个其他功能之前，无法接收或发送另外一个完整的数据字节，它可以保持时钟线路 SCL 为低电平，以强制控制器进入等待状态（时钟延展）。当目标准备好接收另一个数据字节并释放时钟线 SCL 时，数据传输将继续。

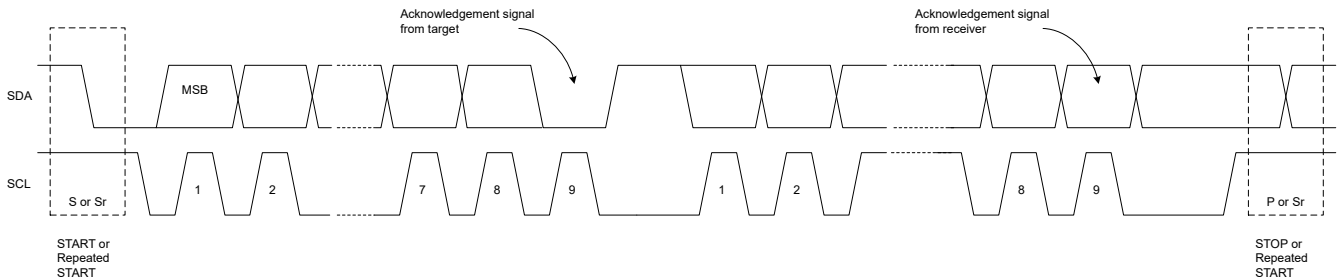


图 7-10. 字节格式

7.5.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)

确认会在每个字节之后发生。确认位允许接收器向发送器发送信号，指示已成功接收该字节且可发送另一个字节。所有时钟脉冲（包括确认第九个时钟脉冲）均由控制器生成。

在应答时钟脉冲期间，发送器释放 SDA 线，以便接收器将 SDA 线拉低，并在时钟脉冲为高电平时保持稳定的低电平。

非确认信号是指 SDA 在第九个时钟脉冲期间保持高电平。然后，控制器可以生成 STOP（停止）来中止传输，或者生成重复的 START（开始）来开始新的传输。

7.5.5 目标地址和数据方向位

在 START 之后会发送目标地址。该地址为 7 位长，后跟第八位作为数据方向位（位 $\overline{R/W}$ ）。零表示传输 (WRITE)，一表示数据请求 (READ)。

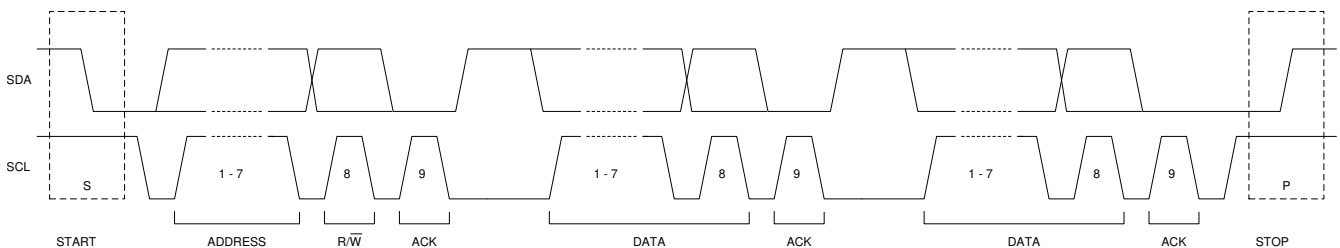


图 7-11. 目标地址和数据方向

7.5.6 单独读取和写入

图 7-12 和图 7-13 所示为 I²C 通信的单字节写入和单字节读取格式。



图 7-12. 单字节写入



图 7-13. 单字节读取

如果未定义寄存器地址，TLV612901 会发回 NACK 并返回到空闲状态。

7.5.7 多重读取和多重写入

TLV612901 支持多次读取和多次写入。

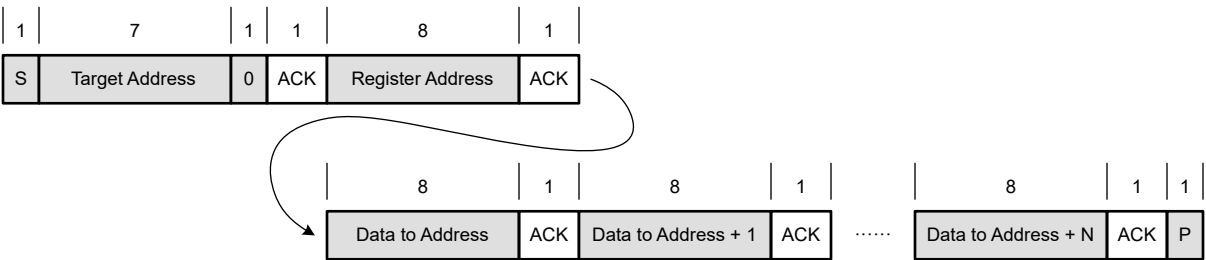


图 7-14. 多字节写入

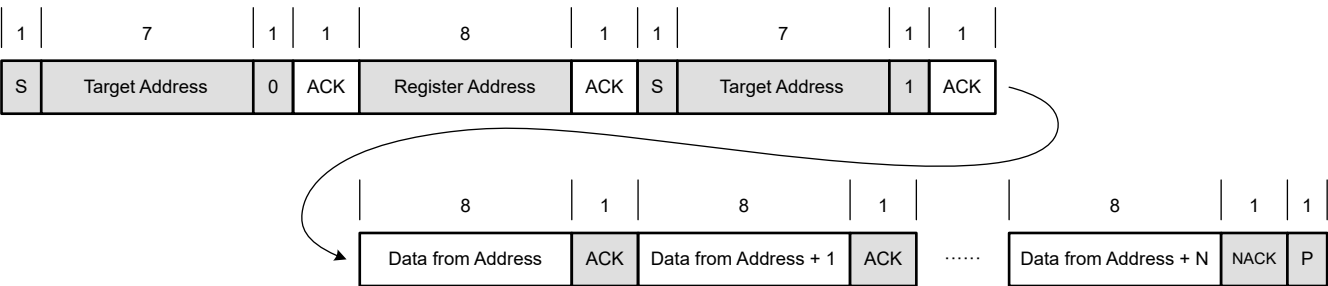


图 7-15. 多字节读取

8 寄存器映射

配置存储器映射列出了该器件寄存器的存储器映射寄存器。配置存储器映射中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留位置，并且不应修改寄存器内容。

表 8-1. 器件寄存器

寄存器地址	寄存器名称	说明
00h	DeviceID 寄存器	设置制造商 ID 和器件版本 ID
01h	CONFIG 寄存器	设置其他配置位
02h	VOUTFLOORSET 寄存器	设置下限输出电压阈值升压/旁路模式更改
03h	ILIMBSTSET 寄存器	设置直流/直流升压模式下的输入电流限值
04h	VOUTROOFSET 寄存器	设置上限输出电压阈值升压/旁路模式更改 (仅当 GPIO 配置为 VSEL 功能时有效)
05h	STATUS 寄存器	返回状态标志
06h	ILIMPTSET 寄存器	设置旁路模式下的输入电流限值
07h	BSTLOOP 寄存器	设置内部补偿环路

8.1 DeviceID 寄存器

存储器位置：0x00

表 8-2. VersionID 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7:4	制造 ID	R	0111	制造商 ID。
3:0	器件 ID	R	0000	器件版本 ID。

8.2 CONFIG 寄存器

存储器位置：0x01

表 8-3. CONFIG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	复位	R/W	0	器件复位位。 0：正常运行。 1：所有内部寄存器均设置默认值。器件开始循环运行 (ON-OFF-ON)，即转换器会在短时间内禁用并且输出会复位。
6:5	ENABLE	R/W	01	器件使能位（请参阅 运行模式设置 ）。 00 或 01：器件在自动升压或旁路模式下运行。 10：器件强制处于强制旁路模式。 11：器件处于关断模式，但 I ² C 处于活动状态。
4	HICCUP_MODE	R/W	1	断续模式使能位。 0：断续模式禁用 1：断续模式启用
3	DISCHG	R/W	1	输出放电使能位。 0：当器件处于 I ² C 关断模式时禁用 VOUT 放电。 1：当器件处于关断模式时启用 VOUT 放电。 (请参阅 输出放电)
2	SSFM	R/W	0	展频调制控制。 0：禁用展频调制。 1：在强制 PWM 模式下启用展频调制
1:0	MODE_CTRL	R/W	00	器件轻负载功能模式位。 00：设备在 自动 PFM 模式 下运行。 01：设备在 超声波模式 下运行。 10 或 11：器件在 强制 PWM 模式 下运行。

8.3 VOUTFLOORSET 寄存器

存储器位置：0x02

表 8-4. VOUTFLOORSET 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7:6	RESERVED	R/W	00	保留位。 保留这些位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
5:0	VOUTFLOOR_TH	R/W	1	输出电压阈值，直流/直流升压/旁路模式更改。
		R/W	0	
		R/W	1	000000 : 2.85V 100000 : 4.45V
		R/W	0	000001 : 2.90V 100001 : 4.50V
		R/W	1	000010 : 2.95V 100010 : 4.55V
		R/W	0	000011 : 3.00V 100011 : 4.60V
		R/W	1	000100 : 3.05V 100100 : 4.65V
		R/W	1	000101 : 3.10V 100101 : 4.70V
				000110 : 3.15V 100110 : 4.75V
				000111 : 3.20V 100111 : 4.80V
				001000 : 3.25V 101000 : 4.85V
				001001 : 3.30V 101001 : 4.90V
				001010 : 3.35V 101010 : 4.95V
				001011 : 3.40V 101011 : 5.00V
				001100 : 3.45V 101100 : 5.05V
				001101 : 3.50V 101101 : 5.10V
				001110 : 3.55V 101110 : 5.15V
				001111 : 3.60V 101111 : 5.20V
				010000 : 3.65V 110000 : 5.25V
				010001 : 3.70V 110001 : 5.30V
				010010 : 3.75V 110010 : 5.35V
				010011 : 3.80V 110011 : 5.40V
				010100 : 3.85V 110100 : 5.45V
				010101 : 3.90V 110101 : 5.50V
				010110 : 3.95V 110110 : 2.80V
				010111 : 4.00V 110111 : 2.75V
				011000 : 4.05V 111000 : 2.70V
				011001 : 4.10V 111001 : 2.65V
				011010 : 4.15V 111010 : 2.60V
				011011 : 4.20V 111011 : 2.55V
				011100 : 4.25V 111100 : 2.50V
				011101 : 4.30V 111101 : 2.45V
				011110 : 4.35V 111110 : 2.40V
				011111 : 4.40V 111111 : 2.35V

8.4 ILIMBSTSET 寄存器

存储器位置：0x03

表 8-5. ILIMBSTSET 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0	保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
6	RESERVED	R/W	0	保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
5	RESERVED	R/W	0	保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
4	RESERVED	R/W	0	保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
3:0	ILIM_BOOST	R/W	0	直流/直流升压模式下的电感器平均电流限值。 0000 : 5A 0001 : 5.5A 0010 : 6A 0011 : 6.5A 0100 : 7A 0101 : 7.5A 0110 : 8A 0111 : 8.5A 1000 : 9A 1001 : 9.5A 1010 : 10A 1011 : 10.5A 1100 : 11A 1101 : 3.5A 1110 : 4A 1111 : 4.5A
		R/W	1	
		R/W	1	
		R/W	0	

8.5 VOUTROOFSET 寄存器

存储器位置：0x04

表 8-6. VOUTROOFSET 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7:6	RESERVED	R/W	00	保留位。 保留这些位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
5:0	VOUTROOF_TH	R/W	1	输出电压阈值，直流/直流升压/旁路模式更改。
		R/W	0	
		R/W	1	000000 : 2.85V 100000 : 4.45V
				000001 : 2.90V 100001 : 4.50V
		R/W	1	000010 : 2.95V 100010 : 4.55V
		R/W	1	000011 : 3.00V 100011 : 4.60V
				000100 : 3.05V 100100 : 4.65V
				000101 : 3.10V 100101 : 4.70V
				000110 : 3.15V 100110 : 4.75V
				000111 : 3.20V 100111 : 4.80V
				001000 : 3.25V 101000 : 4.85V
				001001 : 3.30V 101001 : 4.90V
				001010 : 3.35V 101010 : 4.95V
				001011 : 3.40V 101011 : 5.00V
				001100 : 3.45V 101100 : 5.05V
				001101 : 3.50V 101101 : 5.10V
				001110 : 3.55V 101110 : 5.15V
				001111 : 3.60V 101111 : 5.20V
				010000 : 3.65V 110000 : 5.25V
				010001 : 3.70V 110001 : 5.30V
				010010 : 3.75V 110010 : 5.35V
				010011 : 3.80V 110011 : 5.40V
				010100 : 3.85V 110100 : 5.45V
				010101 : 3.90V 110101 : 5.50V
				010110 : 3.95V 110110 : 2.80V
				010111 : 4.00V 110111 : 2.75V
				011000 : 4.05V 111000 : 2.70V
				011001 : 4.10V 111001 : 2.65V
				011010 : 4.15V 111010 : 2.60V
				011011 : 4.20V 111011 : 2.55V
				011100 : 4.25V 111100 : 2.50V
				011101 : 4.30V 111101 : 2.45V
				011110 : 4.35V 111110 : 2.40V
				011111 : 4.40V 111111 : 2.35V

8.6 STATUS 寄存器

存储器位置：0x05

表 8-7. 状态寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	TSD	R	0	热关断状态位。 0：正常运行。 1：热关断跳变。此标志在读数后复位。
6	CRC_PASS	R	1	OTP 测试状态位。 0：OTP 测试失败。该位保留供 TI 的测试工程师使用。 1：正常运行。此标志在读数后复位。
5	VOUT_START	R	1	Vout 状态位。 0：Vout < 0.8V。 1：Vout > 0.8V。 此标志在读数后复位。
4	OPMODE	R	1	器件运行模式状态位。 0：器件在旁路模式下运行。 1：器件在升压模式下运行。
3	ILIMPT	R	0	电流限值状态位（旁路模式）。 0：正常运行。 1：表示已触发旁路 FET 电流限值。此标志在读数后复位。
2	ILIMBST	R	0	电流限值状态位（直流/直流升压模式）。 0：正常运行。 1：表示在直流/直流升压模式下已触发平均输入电流限值达 4ms。此标志在读数后复位。
1	FL_LD	R	0	电流限值状态位（直流/直流升压模式）。 0：正常运行。 1：表示在直流/直流升压模式下触发了平均输入电流限值。此标志在读数后复位。
0	PGOOD	R	1	电源正常状态位。 0：表示输出电压没有进行稳压调节。 1：表示输出电压在其标称范围内。如果转换器在自动旁路模式下运行，则该位设置为 1。

8.7 ILIMPTSET 寄存器

存储器位置：0x06

表 8-8. ILIMPTSET 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0	保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
6	RESERVED	R/W	0	保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据，在读取操作期间会返回 0。
5:3	ILIM_FPT	R/W	0	强制旁路模式下的电流限值。 000 : 4A 001 : 6A 010 : 8A 011 : 10A 100 至 111 : 未定义。
		R/W	1	
		R/W	0	
2:0	ILIM_APT	R/W	0	自动旁路模式下的电流限值。 000 : 4A 001 : 6A 010 : 8A 011 : 10A 100 至 111 : 未定义。
		R/W	1	
		R/W	0	

8.8 BSTLOOP 寄存器

存储器位置：0x07

表 8-9. BSTLOOP 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7:3	TI_internal	R/W	01000	TI 内部使用。请勿读取或写入。
2:0	RC	R/W	000	补偿电阻器设置位。 000 : 200k 001 : 250k 010 : 100k 011 : 150k 100 : 400k 101 : 450k 110 : 300k 111 : 350k

9 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

9.1 应用信息

TLV612901 在需要 5.0V 稳压输出和高输出电流能力的单节电池供电系统中通常用作高功率前置稳压器。

在升压应用中，当输入电压低于目标输出电压时，该器件可保持稳定的输出电压。该器件还可以在旁路模式下运行，以最大限度地提高效率。

请遵循下述设计流程，以完成 TLV612901 外部器件的选型。

9.2 典型应用

9.2.1 具有 2.5V – 4.85V V_{IN} 、5.0V V_{OUT} 、3A 输出电流的 TLV612901

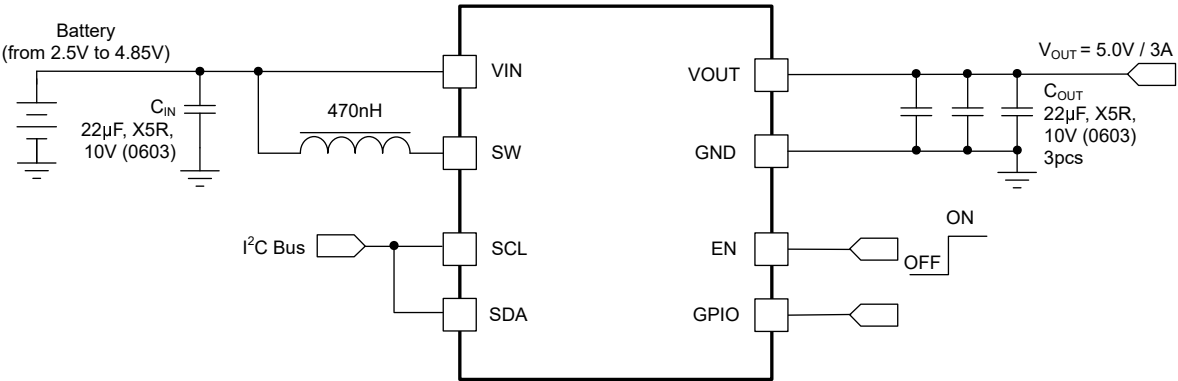


图 9-1. 具有 2.5V – 4.85V V_{IN} 、5.0V V_{OUT} 、3A 输出电流的 TLV612901

9.2.1.1 设计要求

表 9-1. 设计参数

基准	说明	示例值
V_{IN}	输入电压范围	2.5V 至 4.85V
V_{OUT}	升压模式下的输出电压范围	$V_{OUT} = 5.0V$
	旁路模式下的输出电压范围	$V_{OUT} = V_{IN} - I_{OUT} \times R_{DS(ON_BYP)}$
I_{OUT}	输出电流	3A

9.2.1.2 详细设计过程

9.2.1.2.1 电感器选型

升压转换器通常需要两个主要无源元件，用于在转换过程中储存能量：一个电感器和一个输出电容器。建议选择饱和电流额定值高于潜在峰值电流（流经电源开关）的电感器。

电感器峰值电流随负载、输入和输出电压的变化而变化。使用[方程式 7](#) 计算电感器峰值电流。

$$I_{L(PEAK)} = \frac{V_{IN} \times D}{2 \times f \times L} + \frac{I_{OUT}}{(1-D) \times \eta} \text{ with } D = 1 - \frac{V_{IN}}{V_{OUT}} \quad (7)$$

选择饱和性能不足的电感器会导致转换器峰值电流过高。该电流最终会损坏器件，并降低器件的可靠性。

电感器及电感选型时的重要参数包括：最大额定电流、串联电阻和工作温度。使电感器直流电流额定值大于最大输入平均电流。另请参阅[电流限制操作](#)。

$$I_{L(DC)} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times \frac{1}{\eta} \times I_{OUT} \quad (8)$$

TLV612901 系列升压转换器经过优化，可在有效电感值为 330nH 至 560nH 的范围下运行。更大或更小的电感值用于在特定工作条件下优化器件性能。另请参阅[检查环路稳定性](#)。

线圈的总损耗由直流电阻 (R_{DC}) 损耗和以下与频率相关元件的损耗组成：

- 磁芯材料中的损耗（磁迟滞损耗，尤其是在高开关频率条件下）
- 趋肤效应对导体产生的额外损耗（高频下的电流位移）
- 相邻绕组的磁场损耗（接近效应）
- 辐射损耗

TI 建议将以下不同供应商的系列电感器与 TLV612901 搭配使用。

表 9-2. 电感器列表

串联	L (nH)	尺寸 (单位: mm)	直流输入电流限值设置	制造商 ⁽¹⁾
HTTO32251T-R47MMR	470	最大高度为 3.2 × 2.5 × 1.0	≤8600mA	Cyntec
744383340047	470	最大高度为 3.4 × 3.4 × 1.2	≤9400mA	Würth Elektronik
XGL4012-451	450	最大高度为 4.0 × 4.0 × 1.2	≤9900mA	Coilcraft
DFE32CAHR47MR0	470	最大高度为 3.2 × 2.5 × 2.0	≤8700mA	Murata

(1) 请参阅[第三方产品免责声明](#)。

9.2.1.2.2 输出电容器

对于输出电容器，TI 建议使用尽可能靠近 IC 的 V_{OUT} 和 GND 引脚放置的小型陶瓷电容器。如果无法将大电容器放置在 IC 附近，TI 强烈建议在 IC 旁并联一个小型陶瓷电容器。要获得建议的最小输出电容估值，请使用 [方程式 9](#)。

$$C_{\text{MIN}} = \frac{I_{\text{OUT}} \times (V_{\text{OUT}} - V_{\text{IN}})}{f \times \Delta V \times V_{\text{OUT}}} \quad (9)$$

其中 f 为开关频率， ΔV 为最大允许输出纹波。

由于直流偏置效应，应选用容量是计算所得最小值两倍的 MLCC 电容器。该电容器用于确保控制环路的稳定性。输出电容器需要 X7R 或 X5R 电介质。除了电容会随温度显著变化外，Y5V 和 Z5U 电介质电容器还会再高频下呈现电阻特性。在最小 ESR 方面并无额外要求。在负载瞬态期间，大型电容器可实现较低的输出电压纹波以及较低的输出压降。

对于大多数应用方案，TI 建议使用 3 个 22 μ F X5R 10V (0603) MLCC 电容器。在具有高（脉冲）负载电流的应用中（例如：5V / 3A），TI 建议增大输出电容器以确保有足够的有效输出电容，例如使用四个 22 μ F X5R 10V (0603) MLCC。

高容值陶瓷电容器会表现出直流偏置效应，这会对器件的有效电容产生显著影响。因此，必须仔细选择正确的电容器值。封装尺寸和额定电压以及材料是造成额定电容值和有效电容之间差异的原因。例如，一个 22 μ F X5R 6.3V (0603) MLCC 电容器的有效电容通常小于 10 μ F（在 3.4V 直流偏置和 20mV 交流偏置条件下）。

9.2.1.2.3 输入电容器

因为多层陶瓷电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装，所以非常适合升压转换器的输入去耦。将电容器放置在尽可能靠近器件的位置。22 μ F 的输入电容器足以满足大部分应用的需求。为进一步不受限制地降低输入电流纹波，请采用更大参数值。

仅使用陶瓷输入电容器时要小心。在输入端使用陶瓷电容器并且通过长导线（例如来自插墙式适配器中）供电时，输出端的负载阶跃会在 V_{IN} 引脚处引起振铃。此振铃可耦合到输出端，可能被误判为环路不稳定或损坏器件。为了减少电源引线电感和 C_{IN} 之间产生的振铃，请在 C_{IN} 和电源之间放置“大容量”电容（电解电容或钽电容）。

9.2.1.2.4 检查环路稳定性

评估电路和稳定性的第一步是从稳态角度查看以下信号：

- 开关节点，SW
- 电感器电流，I_L
- 输出纹波电压，V_{OUT(AC)}

这些信号是评估开关转换器时必须测量的基本信号。调节环路的不稳定迹象包括出现较大占空比抖动的开关波形，或者输出电压或电感器电流出现振荡。该事件通常是电路板布局或 L-C 一同造成的结果。

调节环路评估的下一步测试负载瞬态响应。在施加负载瞬态到 N 沟道 MOSFET 导通的时间间隔内，使输出电容器能够提供负载所需的所有电流。V_{OUT} 将立即变化，幅度等于 $\Delta I_{(\text{LOAD})} \times \text{ESR}$ ，其中 ESR 是 C_{OUT} 的有效串联电阻。 $\Delta I_{(\text{LOAD})}$ 开始对 C_{OUT} 进行充电或放电，从而生成稳压器可用的反馈误差信号，使 V_{OUT} 恢复到其稳态值。当器件在 PWM 模式下运行时，结果最易解读。

在该恢复期间，可监测 V_{OUT} 的建立时间、过冲或振铃以帮助判断转换器的稳定性。如果没有任何振铃，环路的相位裕度通常大于 45°。由于电路的阻尼因子与几个基于温度的阻性参数（即 MOSFET r_{DS(on)}）直接相关，因此必须在输入电压范围、负载电流范围和温度范围内进行环路稳定性分析。

TLV612901 系列升压转换器经过优化，可在有效电感值为 330nH 至 560nH、输出电容器值为 15 μ F 至 100 μ F 的范围内运行。内部补偿针对 L = 470nH 和有效 C_O = 15 μ F 的输出滤波器进行了优化。

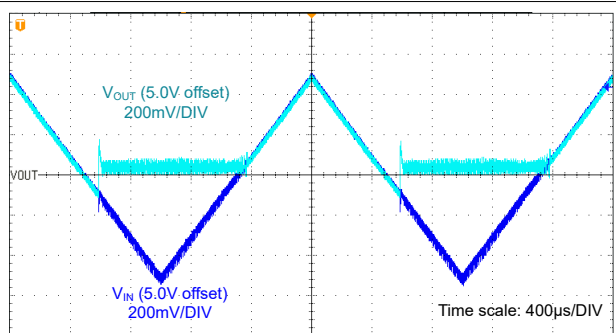
表 9-3. 元件列表

基准	说明	器件型号, 制造商 ⁽¹⁾
C _{IN}	22 μ F、10V、0603、X5R 陶瓷电容器	GRM187R61A226ME15D
C _{OUT}	3 $\times$ 22 μ F, 10V, 0603, X5R 陶瓷	3 $\times$ GRM187R61A226ME15D
L	450nH, 13.8m Ω , 4.0mm $\times$ 4.0mm $\times$ 1.2mm	XGL4012-451

(1) 请参阅 [第三方产品免责声明](#)。

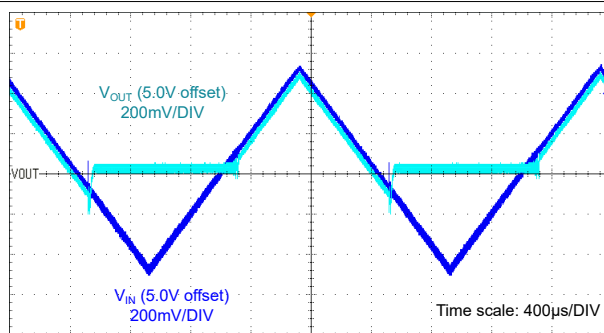
9.2.1.3 应用曲线

典型条件为 $V_{IN} = 2.5V$ 至 $4.85V$ 、 $V_{OUT_TAR} = 5.0V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ ，除非另有说明



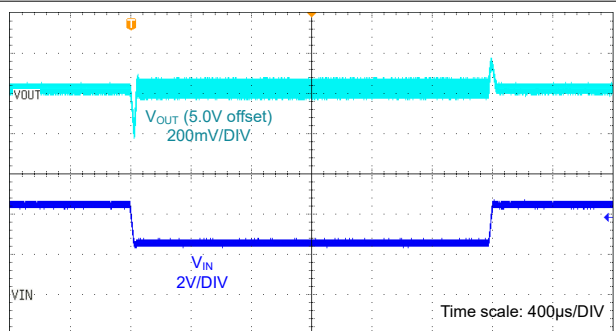
$V_{OUT_TAR} = 5.0V$ $T_A = 25^\circ C$ 自动 PFM 负载 = 100mA

图 9-2. 升压至旁路模式退出/进入



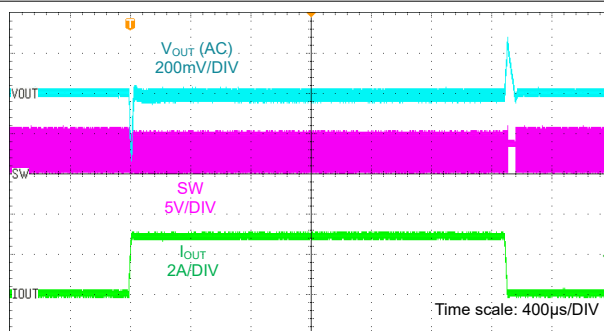
$V_{OUT_TAR} = 5.0V$ $T_A = 25^\circ C$ 自动 PFM 负载 = 3A

图 9-3. 升压至旁路模式退出/进入



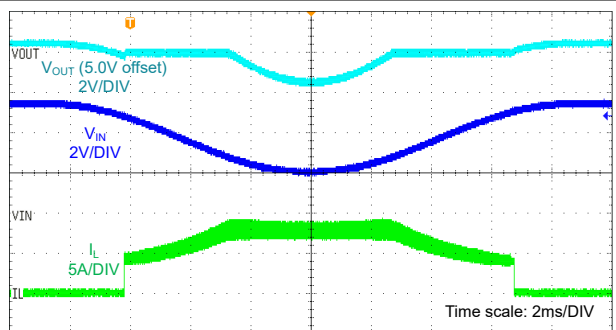
$V_{OUT_TAR} = 5.0V$ $T_A = 25^\circ C$ 自动 PFM 负载 = 3A
 $V_{IN} = 2.7V$ 至 $4.5V$, $20\mu s$ 压摆率

图 9-4. 线路瞬态响应



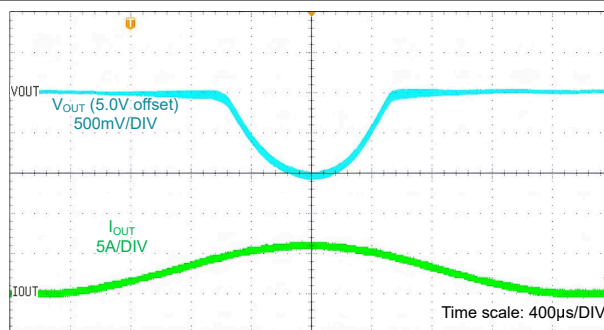
$V_{OUT_TAR} = 5.0V$ $V_{IN} = 3.6V$ 自动 PFM
负载 = 0.1A - 3A, $0.2A/\mu s$ 压摆率

图 9-5. 负载瞬态响应



$V_{OUT_TAR} = 5.0V$ $T_A = 25^\circ C$ 自动 PFM 负载 = 4A
 $V_{IN} = 5.5V$ 至 $2.2V$ 扫描

图 9-6. 线路扫描



$V_{OUT_TAR} = 5.0V$ $V_{IN} = 3.6V$ 自动 PFM
负载 = 0A 至 6A 扫描

图 9-7. 负载扫描

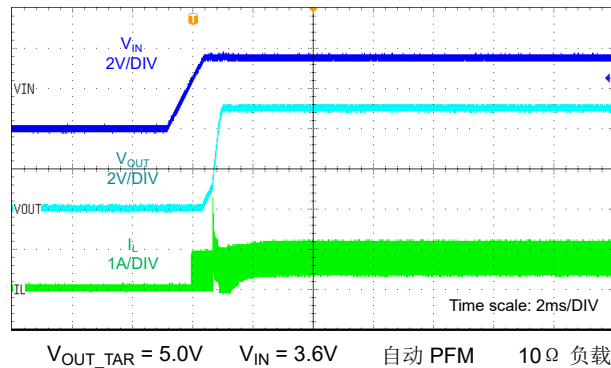


图 9-8. 由 V_{IN} 启动

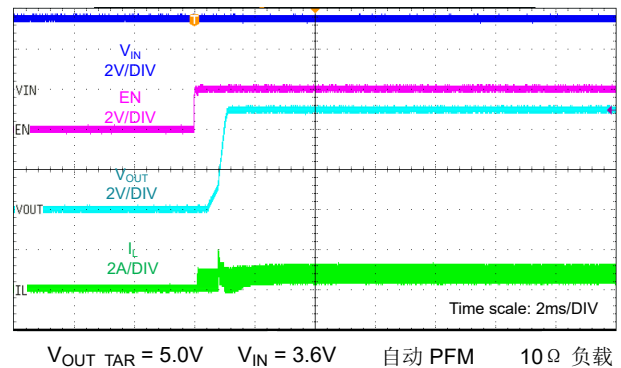


图 9-9. 由 EN 启动

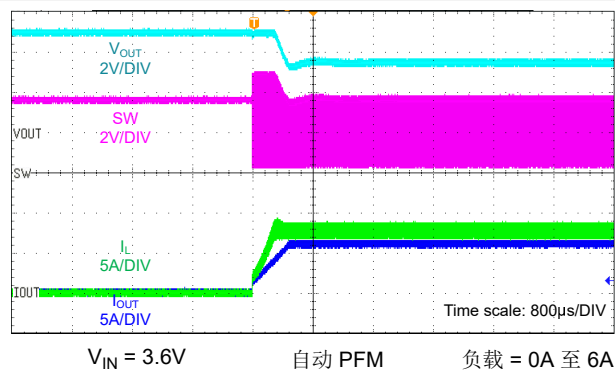


图 9-10. 升压模式下的电流限值运行

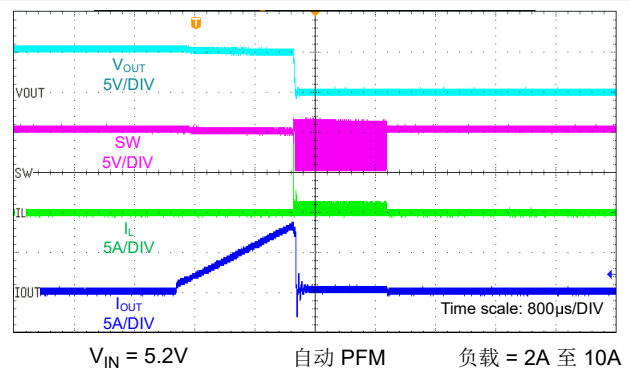


图 9-11. 旁路模式下的电流限值运行

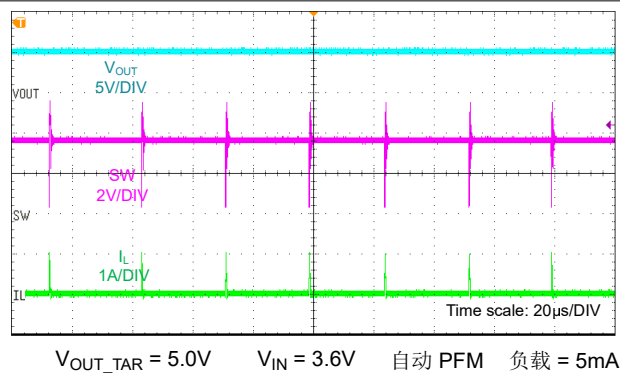


图 9-12. 轻负载条件下的开关波形

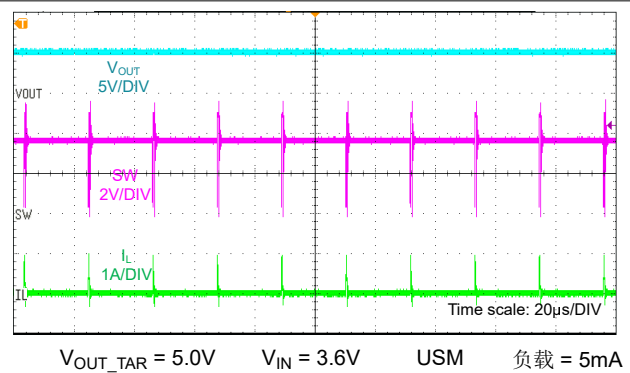


图 9-13. 轻负载条件下的开关波形

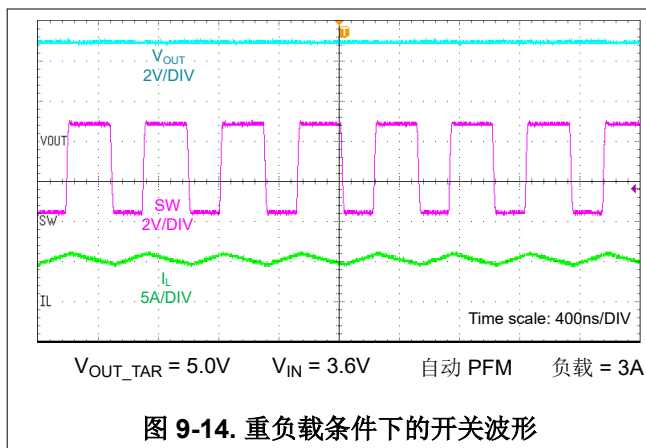


图 9-14. 重负载条件下的开关波形

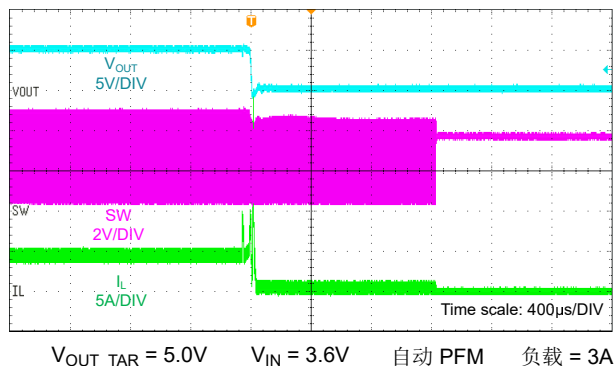


图 9-15. 输出接地短路保护

9.3 电源相关建议

这些器件设计为在 1.8V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。请确认该输入电源得到良好调节。如果输入电源距离 TLV612901 转换器超过几英寸，那么除了陶瓷旁路电容器之外可能还需要额外的大容量电容。通常，选择容值为 47 μ F 的电解电容器或钽电容器。

9.4 布局

9.4.1 布局指南

对于所有开关电源，尤其是以高开关频率和高电流运行的开关电源，布局设计是一个重要的设计步骤。如果未仔细布局，稳压器可能会出现不稳定和噪声问题。由于 TLV612901 运行时开关上升和下降时间非常短，因此可以产生高频噪声辐射（例如 EMI）。因此，高频开关路径的正确布局至关重要。在布局时，应尽量缩短并减小所有连接至 SW 引脚的走线长度和面积，并在开关稳压器下方敷设接地平面。该操作有助于更最大限度地减少层间耦合并优化高频开关路径。

输入电容器必须靠近 V_{IN} 引脚和 $PGND$ 引脚，以降低 I_{input} 电源纹波。 V_{OUT} 、输出电容和 $PGND$ 的电源路径必须尽可能小，以减少寄生电感。

由于该器件具有高功率密度，因此在布局设计过程中必须仔细考虑热管理。 SW 、 V_{OUT} 和 $PGND$ 引脚可改善封装的热性能，必须焊接至大面积铜皮上。此外，在 SW 引脚下方使用散热过孔可以提高热性能。

此外，还应考虑布局过程中 PCB 寄生效应的影响。图 9-16 显示了 TLV612901 中的连续电流路径和不连续电流路径。蓝色实线表示连续电流路径，红色虚线表示不连续电流路径。图 9-17 展示了不连续电流路径中的 PCB 寄生电感器。由功率 MOSFET Q_1 、功率 MOSFET Q_2 、输出电容 C_{OUT} 形成的环路必须尽可能短，因为在这些高 di/dt 电流路径中的 PCB 寄生电感会在输出端和功率 MOSFET 上产生高电压尖峰。开关节点 SW 处的尖峰和振铃是 EMI 的来源，会导致功率 MOSFET 过压损坏。为了最大程度地减小 PCB 寄生电感 L_{para1} 和 L_{para2} 的影响，最好将低 ESL 和 ESR X5R 或 X7R 电介质陶瓷电容 C_{OUT1} 放置在尽可能靠近 TLV612901 的 V_{OUT} 引脚和 GND 引脚的位置。

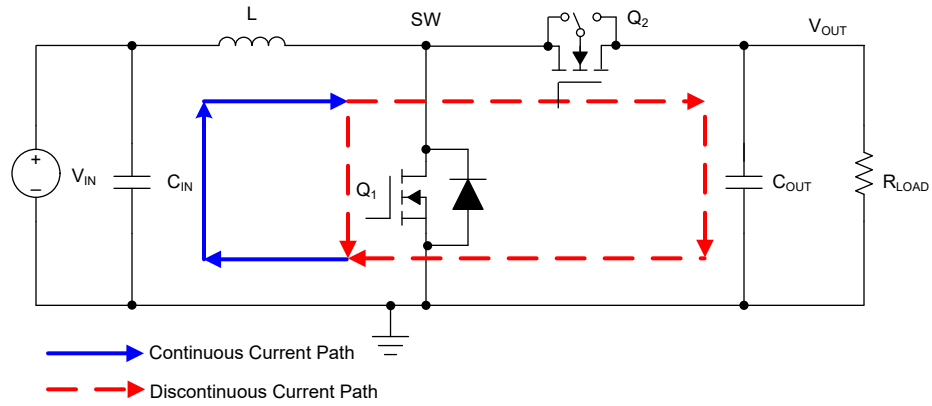


图 9-16. 连续和不连续电流路径

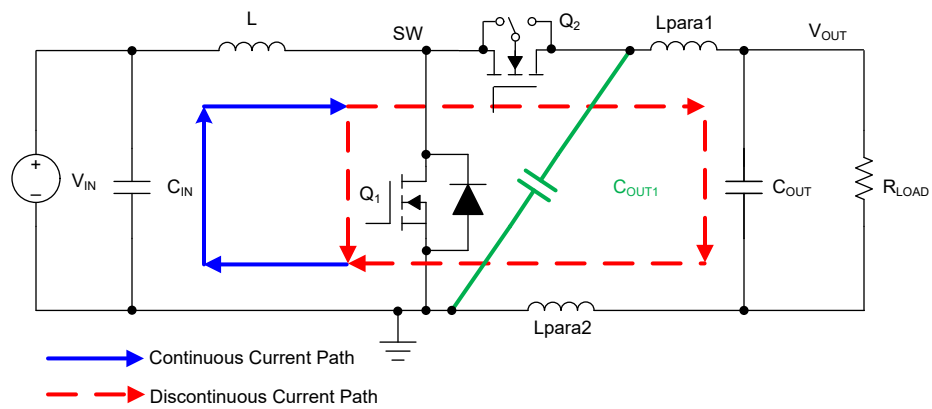


图 9-17. 不连续电流路径中的 PCB 寄生电感器

9.4.2 布局示例

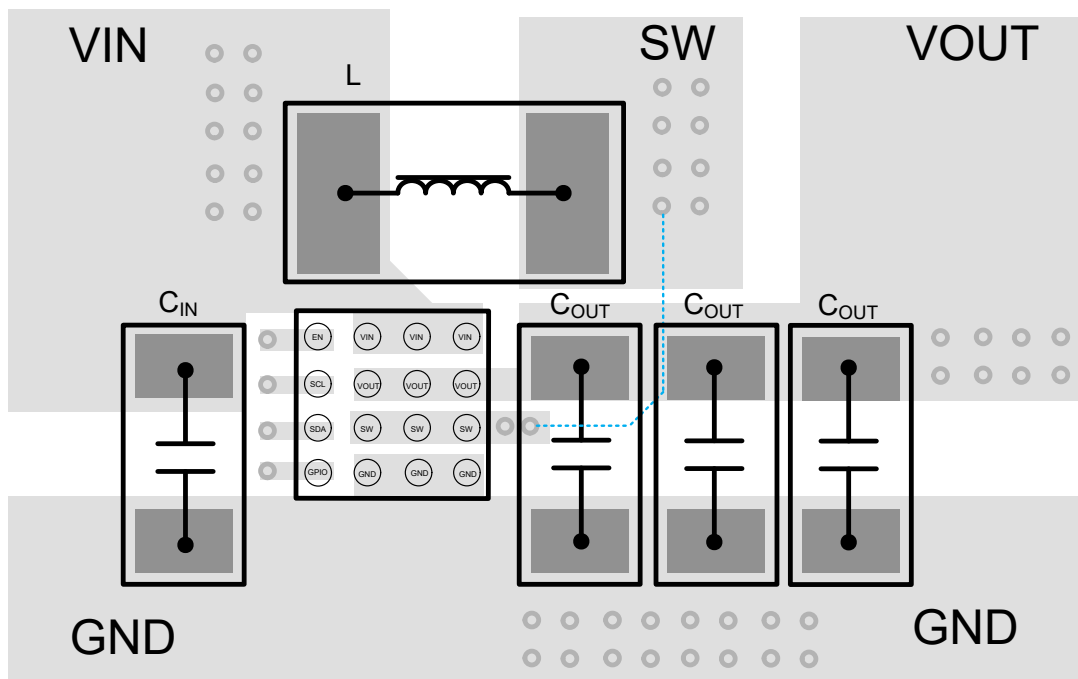


图 9-18. 建议布局 (顶视图)

9.4.3 热性能信息

在薄型和细间距表面贴装封装中实现集成电路通常需要特别注意功率耗散。许多取决于系统的问题（如热耦合、空气流量、添加的散热器和对流表面）以及其他发热元件的存在会影响给定元件的功率耗散限制。

以下列出增强热性能的三种基本方法：

- 增强 PCB 设计的散热能力
- 改善 PCB 与元件之间的热耦合
- 在系统中引入空气流量

功率需求在便携式设计中愈发重要，因此设计人员需要在效率、功耗和设计尺寸之间做出最佳选择。由于集成化和小型化，结温可能会显著升高，从而可能导致应用行为异常（即过早热关断或最坏情况下会降低器件可靠性）。

结至环境热阻与应用和电路板布局布线密切相关。对于存在较高最大功率耗散的应用，需要特别注意电路板设计中的散热问题。确保器件工作结温 (T_J) 低于 125°C。

10 器件和文档支持

10.1 器件支持

10.1.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

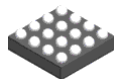
11 修订历史记录

日期	修订版本	注释
August 2026	*	初始发行版

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

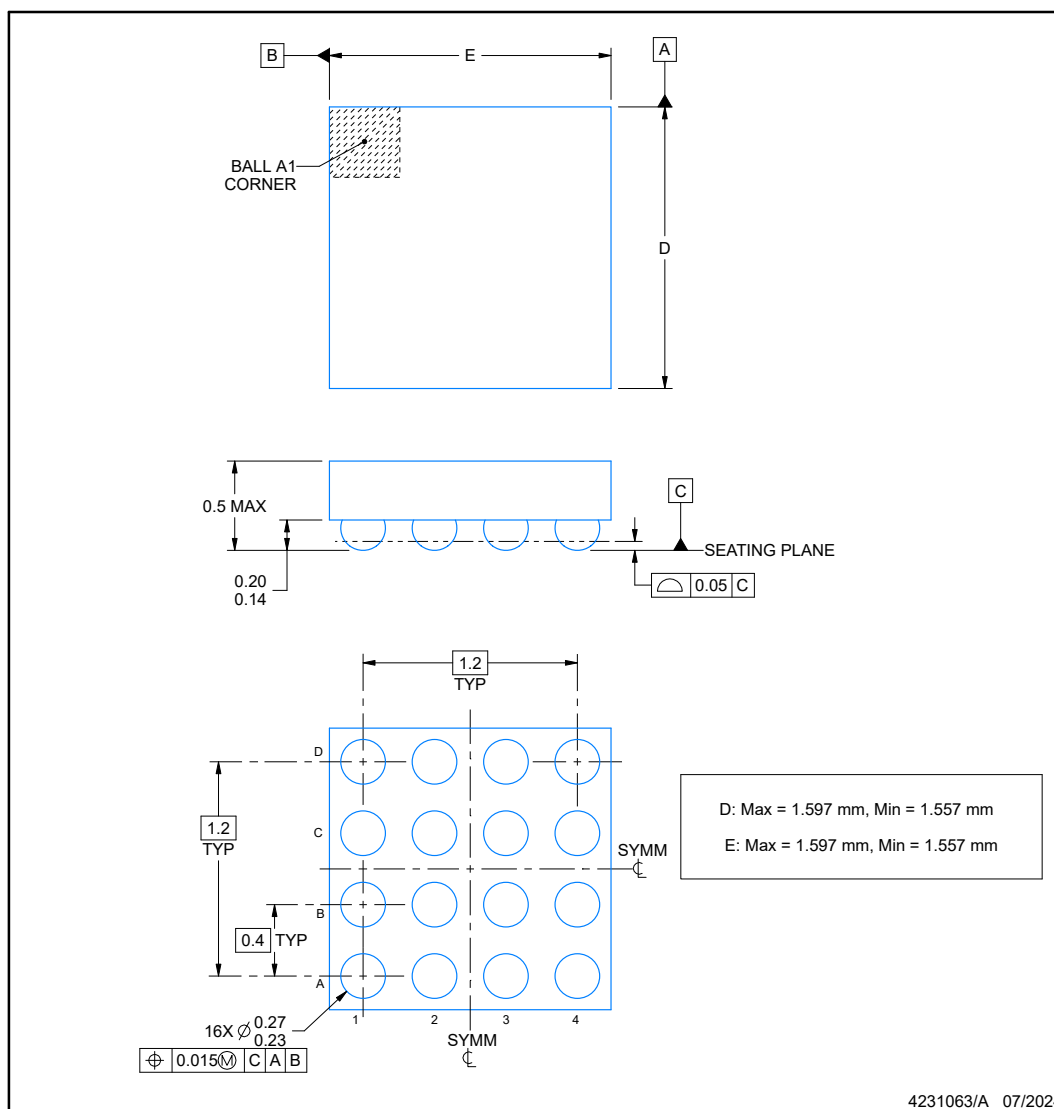
YBG0016-C01



PACKAGE OUTLINE

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY

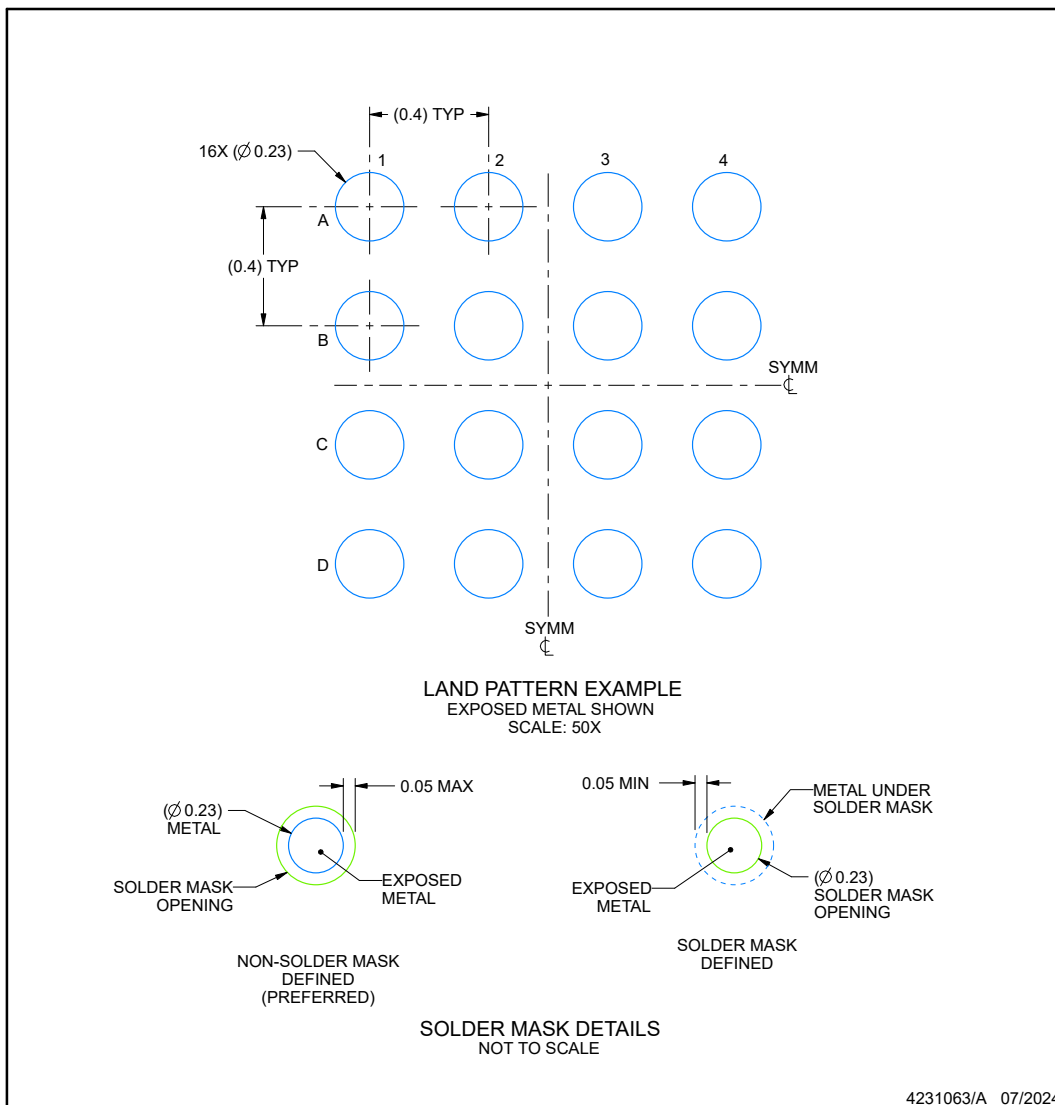


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT**YBG0016-C01****DSBGA - 0.5 mm max height**

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

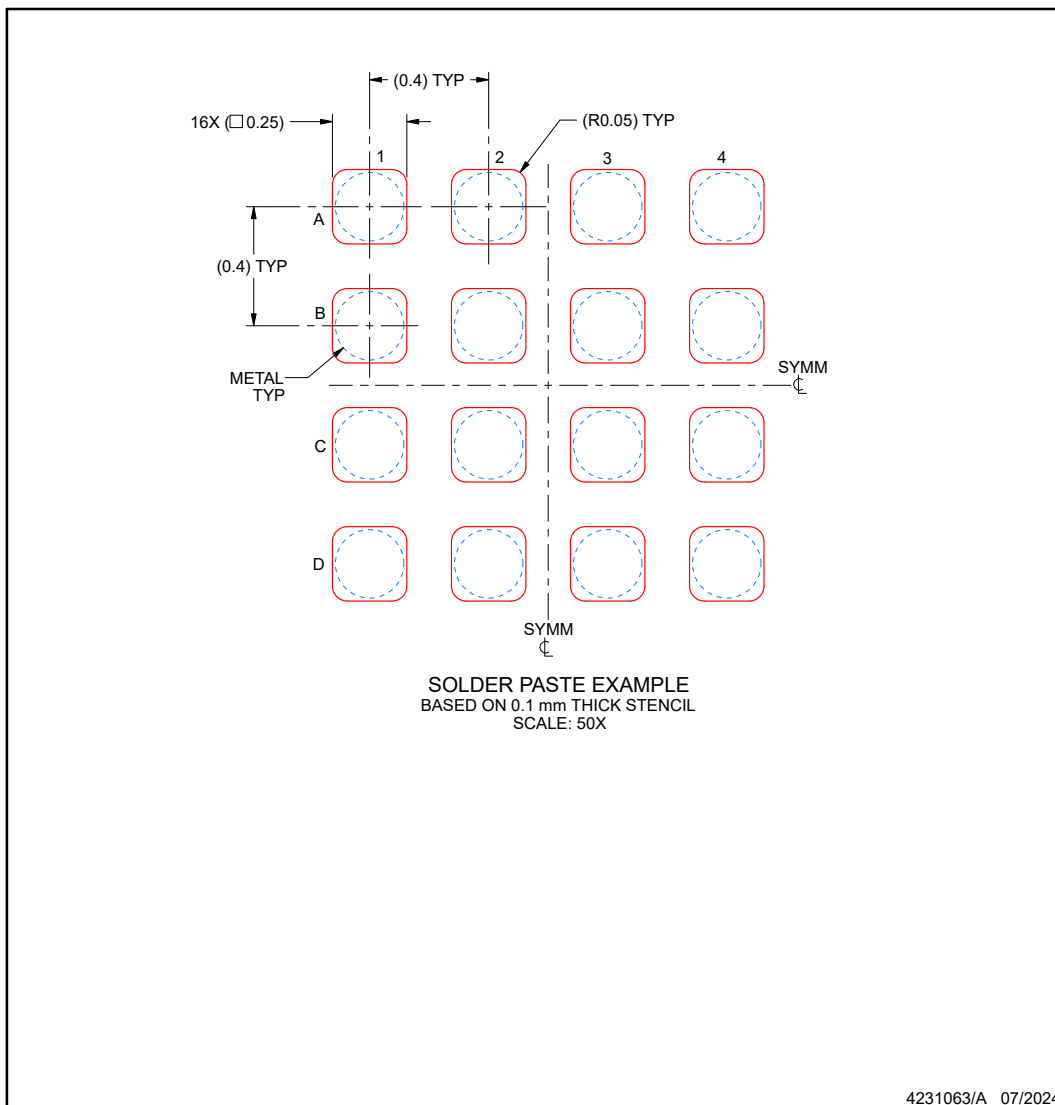
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
 See Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YBG0016-C01

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLV612901YBGR	Active	Production	DSBGA (YBG) 16	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-	27W

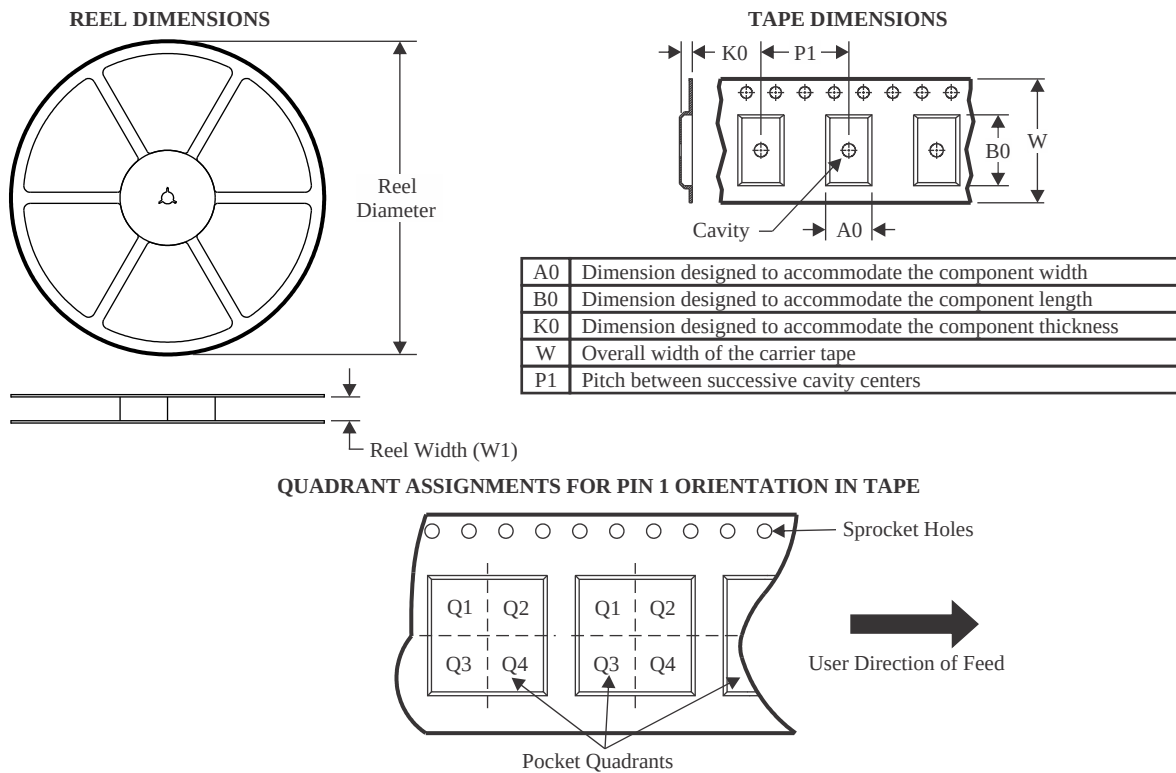
- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

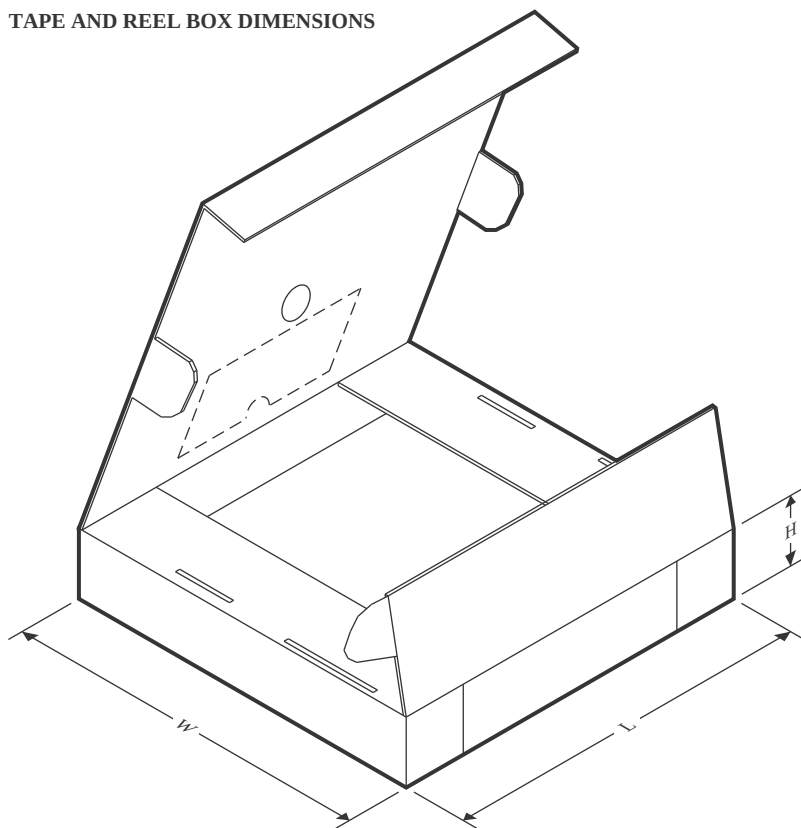
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TLV612901YBGR	DSBGA	YBG	16	3000	180.0	8.4	1.68	1.72	0.62	4.0	8.0	Q1

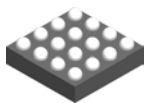
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TLV612901YBGR	DSBGA	YBG	16	3000	182.0	182.0	20.0

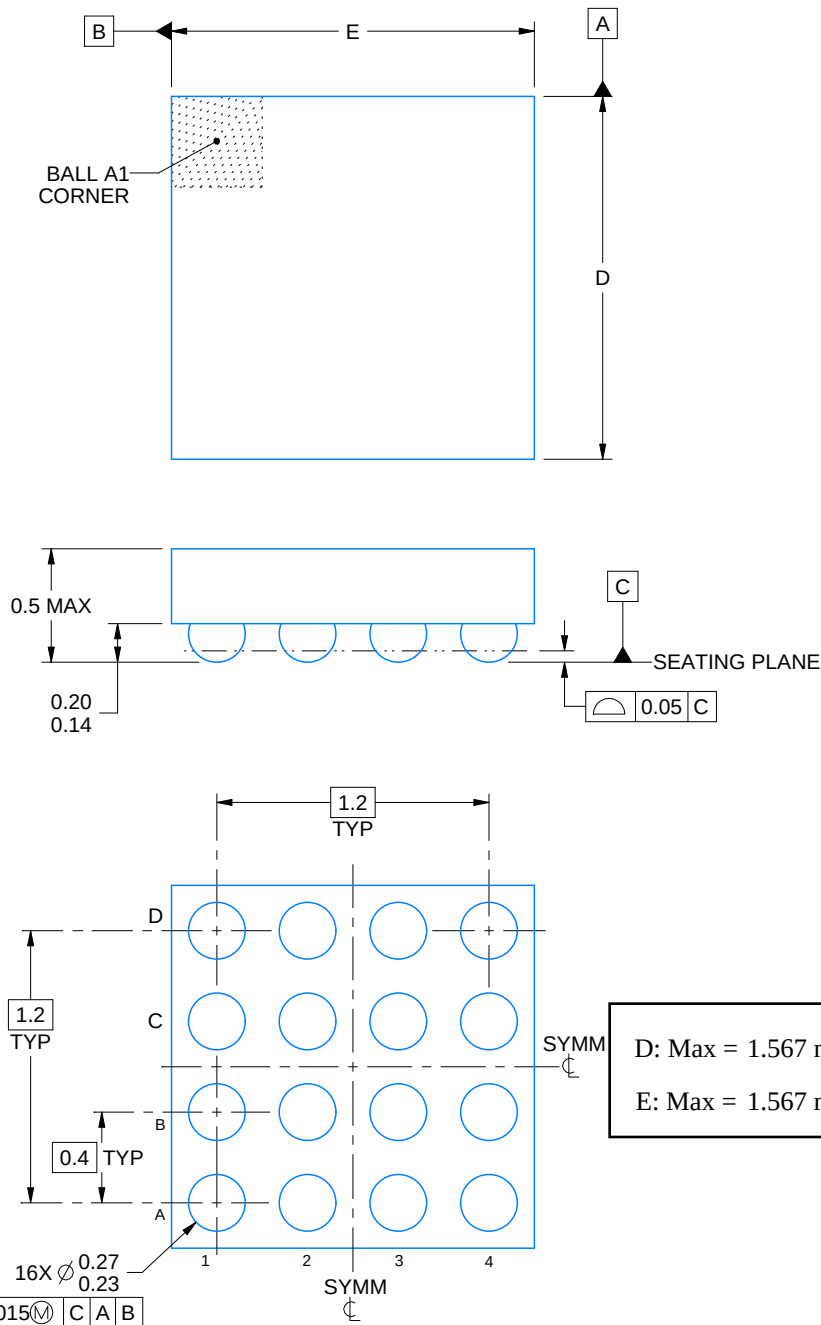
YBG0016



PACKAGE OUTLINE

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



4224950/A 04/2019

NOTES:

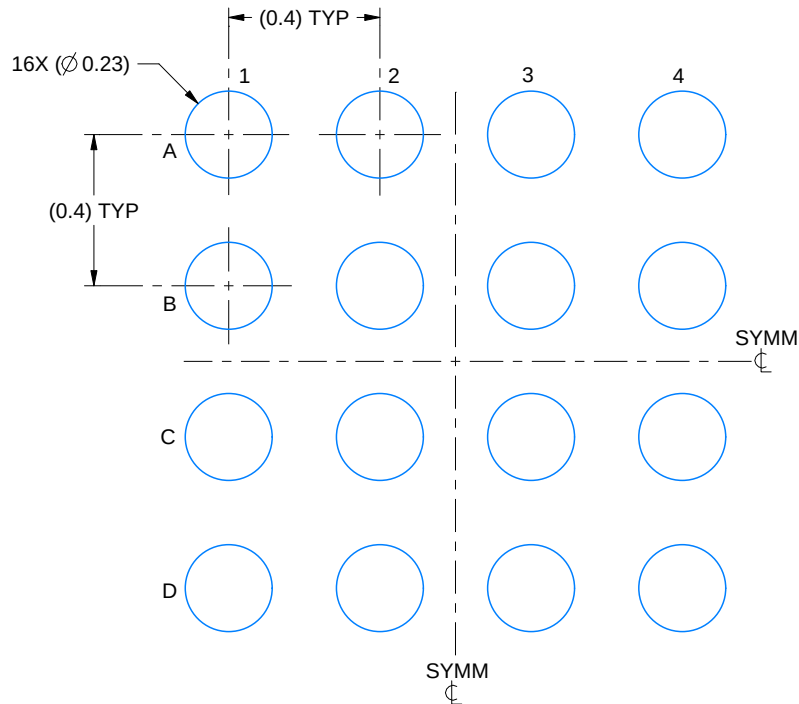
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

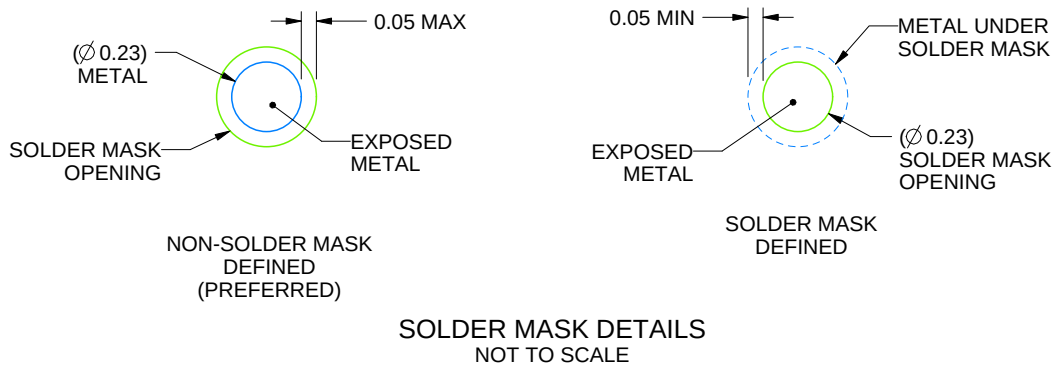
YBG0016

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 50X



4224950/A 04/2019

NOTES: (continued)

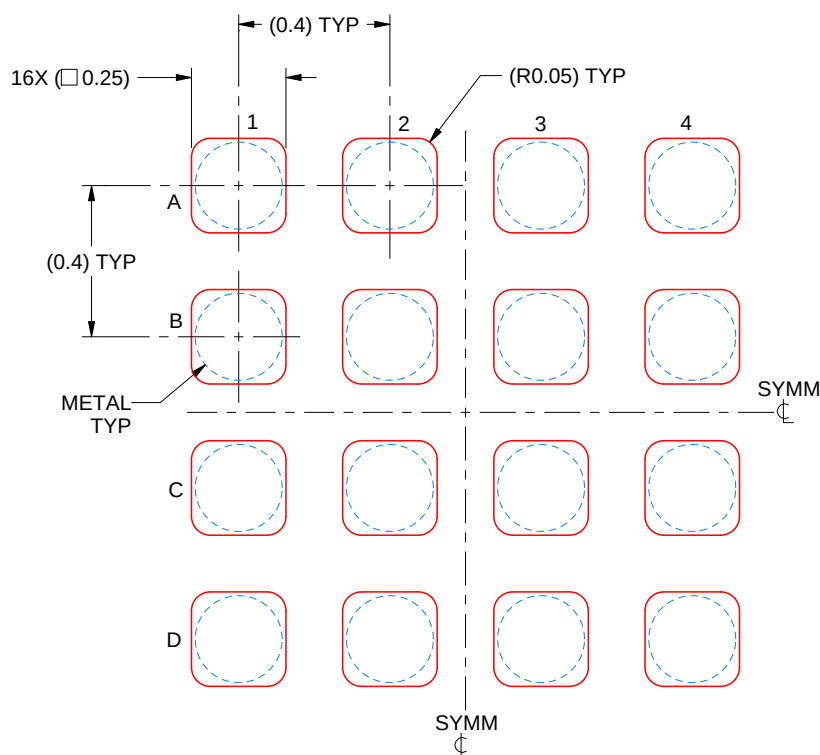
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. See Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YBG0016

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE: 50X

4224950/A 04/2019

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月